

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2008-83171

(P2008-83171A)

(43) 公開日 平成20年4月10日(2008.4.10)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G09G 3/30 (2006.01)	G09G 3/30 J	3K107
G09G 3/20 (2006.01)	G09G 3/20 624B	5C080
H01L 51/50 (2006.01)	G09G 3/20 641D	5F110
H01L 21/336 (2006.01)	H05B 33/14 A	
H01L 29/786 (2006.01)	H01L 29/78 612Z	
審査請求 未請求 請求項の数 19 O L (全 29 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2006-260632 (P2006-260632)
 (22) 出願日 平成18年9月26日 (2006.9.26)

(71) 出願人 000001443
 カシオ計算機株式会社
 東京都渋谷区本町1丁目6番2号
 (74) 代理人 100096699
 弁理士 鹿嶋 英實
 (72) 発明者 武居 学
 東京都八王子市石川町2951番地の5
 カシオ計算機株式会
 社八王子技術センター内
 Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC31 CC32 CC33
 EE03 HH00 HH04 HH05
 5C080 AA06 BB05 DD01 EE29 FF11
 HH09 JJ02 JJ03 JJ04 JJ05

最終頁に続く

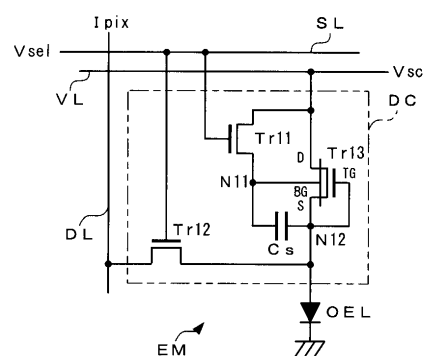
(54) 【発明の名称】 画素駆動回路及び画像表示装置

(57) 【要約】

【課題】表示画素（画素駆動回路）の駆動時に生じる電圧変化に起因する書込電流（指定電流）と発光駆動電流（出力電流）の差異を抑制して、表示データに応じた適切な輝度階調で発光素子を発光動作させることができる画素駆動回路及び画像表示装置を提供する。

【解決手段】画素駆動回路DCは、発光駆動用のスイッチング手段としてのダブルゲート型トランジスタTr13と有機EL素子OLEDが直列に接続され、当該ダブルゲート型トランジスタTr13は、ボトムゲート端子BGが制御電圧が印加される接点N11に、ドレイン端子Dが電源電圧ラインVLに、トップゲート端子TG及びソース端子Sが、有機EL素子OLEDのアノード端子が接続された接点N12に各々接続されている。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

表示画素に設けられた電流制御型の発光素子に対して、階調信号に応じた電流値を有する発光駆動電流を供給して、前記階調信号に基づく所定の輝度階調で発光動作させる画素駆動回路において、

少なくとも、

前記階調信号に基づく電荷を電圧成分として保持する電荷保持手段と、

該電荷保持手段に保持された電圧成分に基づいて、前記発光駆動電流を生成して、前記発光素子に供給する駆動電流制御手段と、

を備え、

前記駆動電流制御手段は、半導体層を挟んで対向して設けられた第 1 のゲート電極及び第 2 のゲート電極と、前記半導体層の両端部に設けられたソース電極及びドレイン電極と、を具備するダブルゲート型の薄膜トランジスタ構造を有し、

前記ソース電極が前記発光素子の一端に接続され、前記第 1 のゲート電極が前記ソース電極の電位と同一になるように設定されていることを特徴とする画素駆動回路。

【請求項 2】

前記駆動電流制御手段は、前記第 1 のゲート電極と前記ソース電極が電氣的に接続されていることを特徴とする請求項 1 記載の画素駆動回路。

【請求項 3】

前記発光素子は、画素電極と、該画素電極上に設けられた発光層と、前記発光層を介して前記画素電極に対向するように設けられた対向電極とを備え、

前記駆動電流制御手段は、前記第 1 のゲート電極と前記ソース電極が前記画素電極に電氣的に接続されていることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の画素駆動回路。

【請求項 4】

前記駆動電流制御手段は、前記第 1 のゲート電極が前記画素電極と一体的に形成されていることを特徴とする請求項 3 記載の画素駆動回路。

【請求項 5】

前記発光素子は、前記画素電極が光透過特性を有する電極材料により形成されていることを特徴とする請求項 3 又は 4 記載の画素駆動回路。

【請求項 6】

前記発光素子は、前記画素電極が光反射特性を有する電極材料により形成されていることを特徴とする請求項 3 又は 4 記載の画素駆動回路。

【請求項 7】

前記駆動電流制御手段は、前記ソース電極及び前記ドレイン電極が前記半導体層上に延在するように設けられていることを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれかに記載の画素駆動回路。

【請求項 8】

前記駆動電流制御手段は、前記半導体層上にブロック絶縁膜を有し、前記ソース電極及び前記ドレイン電極が前記ブロック絶縁膜上に延在するように設けられていることを特徴とする請求項 7 記載の画素駆動回路。

【請求項 9】

前記画素駆動回路は、前記階調信号を前記電荷保持手段に供給するタイミングを制御する階調信号制御手段を備えていることを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれかに記載の画素駆動回路。

【請求項 10】

前記階調信号制御手段は、ダブルゲート型の薄膜トランジスタ構造を有し、半導体層の上方に設けられたゲート電極が遮光性の電極材料により形成されていることを特徴とする請求項 9 記載の画素駆動回路。

【請求項 11】

前記ダブルゲート型の薄膜トランジスタは、前記半導体層がアモルファスシリコンからな

10

20

30

40

50

ることを特徴とする請求項 1 又は 1 0 記載の画素駆動回路。

【請求項 1 2】

前記階調信号は、前記輝度階調に応じた電流値を有する信号電流であることを特徴とする請求項 1 乃至 1 1 のいずれかに記載の画素駆動回路。

【請求項 1 3】

表示パネルに互いに直行するように配設された複数の走査ライン及び複数の信号ラインの各交点近傍に配置された複数の表示画素に対して、前記各信号ラインを介して、表示データに応じた階調信号を供給することにより、前記表示パネルに所望の画像情報を表示する画像表示装置において、

前記各表示画素は、電流制御型の発光素子と、前記発光素子の発光動作を制御する画素駆動回路と、を備え、

前記画素駆動回路は、少なくとも、前記階調信号に基づく電荷を電圧成分として保持する電荷保持手段と、該電荷保持手段に保持された電圧成分に基づいて、前記発光駆動電流を生成して、前記発光素子に供給する駆動電流制御手段と、前記階調信号を前記電荷保持手段に供給するタイミングを制御する階調信号制御手段と、を備え、

前記駆動電流制御手段は、半導体層を挟んで対向して設けられた第 1 のゲート電極及び第 2 のゲート電極と、前記半導体層の両端部に設けられたソース電極及びドレイン電極と、を具備するダブルゲート型の薄膜トランジスタ構造を有し、

前記ソース電極が前記発光素子の一端に接続され、前記第 1 のゲート電極が前記ソース電極の電位と同一になるように設定されていることを特徴とする画像表示装置。

【請求項 1 4】

前記画像表示装置は、少なくとも、

前記走査ラインに選択信号を印加して、前記走査ラインに接続された前記表示画素に設けられた前記階調信号制御手段により、前記階調信号の当該表示画素への書き込みを可能とする選択状態に設定する走査駆動手段と、

前記選択状態に設定された前記表示画素に対応した前記表示データに基づく前記階調信号を生成して、前記信号ラインに供給する信号駆動手段と、を備えることを特徴とする請求項 1 3 記載の画像表示装置。

【請求項 1 5】

前記信号駆動手段から供給される前記階調信号は、前記表示データに応じた電流値を有する信号電流であることを特徴とする請求項 1 4 記載の画像表示装置。

【請求項 1 6】

前記画素駆動回路に設けられる前記駆動電流制御手段は、前記第 1 のゲート電極と前記ソース電極が電氣的に接続されていることを特徴とする請求項 1 3 乃至 1 5 のいずれかに記載の画像表示装置。

【請求項 1 7】

前記発光素子は、画素電極と、該画素電極上に設けられた発光層と、前記発光層を介して前記画素電極に対向するように設けられた対向電極とを備え、

前記画素駆動回路に設けられる前記駆動電流制御手段は、前記第 1 のゲート電極と前記ソース電極が前記画素電極に電氣的に接続されていることを特徴とする請求項 1 5 又は 1 6 記載の画像表示装置。

【請求項 1 8】

前記画素駆動回路に設けられる前記駆動電流制御手段は、前記第 1 のゲート電極が前記画素電極と一体的に形成されていることを特徴とする請求項 1 7 記載の画像表示装置。

【請求項 1 9】

前記発光素子は、有機エレクトロルミネッセント素子であることを特徴とする請求項 1 3 乃至 1 8 のいずれかに記載の画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

10

20

30

40

50

本発明は、画素駆動回路及び画像表示装置に関し、特に、階調信号に応じた発光駆動電流に基づいて、電流制御型の発光素子を所定の輝度階調で発光動作させるための画素駆動回路、及び、該画素駆動回路と上記発光素子とからなる表示画素を２次元配列した表示パネルを備えた画像表示装置に関する。

【背景技術】

【０００２】

従来、有機エレクトロルミネッセント素子（以下、「有機ＥＬ素子」と略記する）や発光ダイオード（ＬＥＤ）等のように、供給される駆動電流の電流値に応じて所定の輝度階調で発光動作する電流制御型の発光素子を具備する表示画素を、２次元配列した表示パネルを備えた発光素子型のディスプレイ（画像表示装置）が知られている。

10

【０００３】

特に、アクティブマトリックス駆動方式を適用した発光素子型ディスプレイは、近年携帯機器を始め、様々な電子機器に広く利用されている液晶表示装置（ＬＣＤ）に比較して、表示応答速度が速く、また、視野角依存性も少なく、高輝度・高コントラスト化、表示画質の高精細化等が可能であるとともに、液晶表示装置の場合のように、バックライトを必要としないので、一層の薄型軽量化が可能である、という極めて優位な特徴を有しており、次世代のディスプレイとして研究開発が盛んに行われている。

【０００４】

そして、このような発光素子型ディスプレイにおいては、上述した電流制御型の発光素子を発光制御するための駆動制御機構や制御方法が種々提案されている。例えば、特許文献１等に記載されているように、表示パネルを構成する各表示画素ごとに、上記発光素子に加えて、該発光素子を発光制御するための複数のスイッチング手段からなる駆動回路（画素駆動回路、又は、発光駆動回路）を備えたものが知られている。

20

【０００５】

以下、従来技術における画素駆動回路を備えた表示装置について簡単に説明する。

図１２は、従来技術における発光素子型ディスプレイの要部を示す概略構成図であり、図１３は、従来技術における発光素子型ディスプレイに適用可能な表示画素（画素駆動回路及び発光素子）の構成例を示す等価回路図である。

【０００６】

特許文献１等に記載されたアクティブマトリクス型の発光素子型ディスプレイは、概略、図１２に示すように、行、列方向に配設された複数の走査ライン（選択ライン）ＳＬｐ及びデータライン（信号ライン）ＤＬｐの各交点近傍に、複数の表示画素ＥＭｐがマトリクス状に配置された表示パネル１１０Ｐと、各走査ラインＳＬｐに接続された走査ドライバ（走査線駆動回路）１２０Ｐと、各データラインＤＬｐに接続されたデータドライバ（データ線駆動回路）１３０Ｐと、を備え、データドライバ１３０Ｐにおいて表示データに応じた階調信号電圧 V_{pix} を生成して、各データラインＤＬｐを介して各表示画素ＥＭｐに供給する構成を有している。

30

【０００７】

ここで、各表示画素ＥＭｐは、例えば図１３に示すように、ゲート端子が走査ラインＳＬｐに、ソース端子及びドレイン端子がデータラインＤＬｐ及び接点Ｎ１１１に各々接続された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）Ｔｒ１１１と、ゲート端子が接点Ｎ１１１に接続され、ソース端子に接地電位 V_{gnd} が印加された薄膜トランジスタＴｒ１１２と、を備えた画素駆動回路ＤＣｐ、及び、該画素駆動回路ＤＣｐの薄膜トランジスタＴｒ１１２のドレイン端子にアノード端子が接続され、カソード端子に接地電位 V_{gnd} よりも低電位の低電源電圧 V_{ss} が印加された有機ＥＬ素子（電流制御型の発光素子）ＯＬＥＤを有して構成されている。

40

【０００８】

なお、図１３において、Ｃｐは、薄膜トランジスタＴｒ１１２のゲート・ソース電極間に形成される寄生容量（保持容量）である。また、薄膜トランジスタＴｒ１１１は、 n チャネル型の電界効果型トランジスタにより構成され、薄膜トランジスタＴｒ１１２は、 p

50

チャンネル型の電界効果型トランジスタにより構成されている。

【0009】

そして、このような構成を有する表示画素 EMp からなる表示パネル $110P$ を備えた表示装置においては、まず、走査ドライバ $120P$ から各行の走査ライン SLp に選択レベル（ハイレベル）の走査信号 $Vsel$ を順次印加することにより、行ごとの表示画素 EMp （画素駆動回路 DCp ）の薄膜トランジスタ $Tr111$ がオン動作して、当該表示画素 EMp が選択状態に設定される。

【0010】

この選択タイミングに同期して、データドライバ $130P$ により表示データに応じた電圧値を有する階調信号 $Vpix$ を生成して、各列のデータライン DLp に印加することにより、当該階調信号 $Vpix$ が各表示画素 EMp （画素駆動回路 DCp ）の薄膜トランジスタ $Tr111$ を介して、接点 $N111$ （すなわち、薄膜トランジスタ $Tr112$ のゲート端子）に印加される。これにより、薄膜トランジスタ $Tr112$ が当該階調信号 $Vpix$ に応じた導通状態でオン動作して、接地電位 $Vgnd$ から所定の発光駆動電流が薄膜トランジスタ $Tr112$ 及び有機 EL 素子 $OLED$ を介して低電源電圧 Vss に流れ、有機 EL 素子 $OLED$ が表示データに応じた輝度階調で発光動作する。

【0011】

次いで、走査ドライバ $120P$ から走査ライン SLp に非選択レベル（ローレベル）の走査信号 $Vsel$ を印加することにより、行ごとの各行の表示画素 EMp の薄膜トランジスタ $Tr111$ がオフ動作して、当該表示画素 EMp が非選択状態に設定され、データライン DLp と画素駆動回路 DCp とが電氣的に遮断される。このとき、薄膜トランジスタ $Tr112$ のゲート端子に印加され、寄生容量 Cp に保持された電圧に基づいて、薄膜トランジスタ $Tr112$ は、オン状態を持続することになり、上記選択状態と同様に、接地電位 $Vgnd$ から所定の発光駆動電流が薄膜トランジスタ $Tr112$ を介して有機 EL 素子 $OLED$ に流れて、発光動作が継続される。この発光動作は、次の表示データに応じた階調信号電圧 $Vpix$ が各行の表示画素 EMp に印加される（書き込まれる）まで、例えば、1 フレーム期間継続するように制御される。

【0012】

このような駆動制御方法は、各表示画素 EMp （画素駆動回路 DCp の薄膜トランジスタ $Tr112$ のゲート端子）に印加する電圧（階調信号電圧 $Vpix$ ）を調整することにより、有機 EL 素子 $OLED$ に流す発光駆動電流の電流値を制御して、所定の輝度階調で発光動作させていることから、電圧指定型（又は、電圧印加型）の階調制御方法と呼ばれている。

【0013】

ところで、このような電圧指定型の階調制御方法に対応した画素駆動回路 DCp を備えた表示画素 EMp においては、選択機能を有する薄膜トランジスタ $Tr111$ や発光駆動機能を有する薄膜トランジスタ $Tr112$ の素子特性（チャンネル抵抗等）が、外部環境（周囲の温度等）や使用時間等に依存してバラツキや変動（劣化）を生じた場合には、発光素子（有機 EL 素子 $OLED$ ）に供給される発光駆動電流が変動することになり、長期間にわたり安定的に所望の発光特性（所定の輝度階調での表示）を実現することが困難になるという問題を有している。

【0014】

また、表示パネルの高精細化を図るために、各表示画素を微細化すると、画素駆動回路 DCp を構成する薄膜トランジスタ $Tr111$ 及び $Tr112$ の動作特性（ソース・ドレイン間電流等）のバラツキが大きくなるため、適正な階調制御が行えなくなり、各表示画素の発光特性にバラツキが生じて表示画質の劣化を招くという問題を有している。

【0015】

そこで、このような問題点を解決する構成として、電流指定型（又は、電流印加型）の階調制御方法に対応した画素駆動回路の構成が知られている。なお、この電流指定型の階調制御方法に対応した表示画素（画素駆動回路）の具体的な構成例については、後述する

10

20

30

40

50

「発明を実施するための最良の形態」において詳しく説明するが、概略、以下のような構成及び動作（機能）を有するものである。

【００１６】

すなわち、電流指定型の階調制御方法に対応した画素駆動回路においては、例えば、少なくとも、表示画素を選択状態に設定し、表示データに応じた階調信号の表示画素（画素駆動回路）への書込動作を制御する選択制御手段（上述した薄膜トランジスタ T_{r111} に対応する）と、書き込まれた階調信号に基づいて、発光素子（有機 EL 素子等）に供給する発光駆動電流の電流値及びその供給状態を制御する駆動電流制御手段（上述した薄膜トランジスタ T_{r112} 及び寄生容量 C_p に対応する）を備え、上記選択制御手段に選択レベルの走査信号が印加されることにより、選択状態に設定されるタイミングで、表示データに応じた電流値を指定した階調電流（階調信号）を流すことにより、駆動電流制御手段により電圧成分に変換して保持するとともに、非選択状態において該電圧成分に基づく電流値を有する発光駆動電流を発光素子に供給することにより、発光素子を所定の輝度階調で継続的に発光動作させるように構成されている。

10

【００１７】

したがって、上記駆動電流制御手段において、各表示画素に供給される表示データに応じた階調電流の電流レベルを電圧レベルに変換する機能（電流／電圧変換機能）と、該電圧レベルに基づく所定の電流値を有する発光駆動電流を発光素子に供給する機能（発光駆動機能）の双方が実現されることになるので、該駆動電流制御手段を単一の能動素子（薄膜トランジスタ）により構成することにより、図１３に示したような画素駆動回路 DCP における複数の薄膜トランジスタ間で生じる動作特性のバラツキに起因して、発光駆動電流が変動し、表示画質が劣化するという現象を抑制することができるという利点を有している。

20

【００１８】

【特許文献１】特開２００２－１５６９２３号公報（第３頁～第４頁、図１、図２）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【００１９】

しかしながら、上述したような画素駆動回路を有する表示画素が２次元配列された表示パネルを備えた画像表示装置においては、以下に示すような問題を有していた。

30

すなわち、各表示画素において、画素駆動回路（駆動電流制御手段）により生成された発光駆動電流を発光素子に流すことにより、表示データに応じた輝度階調で発光動作させる駆動制御方法においては、駆動電流制御手段となる薄膜トランジスタの電流路が発光素子（有機 EL 素子等）に対して直列に接続され、さらに、当該薄膜トランジスタと発光素子からなる直列回路が所定の電圧源（一定の電位差間）に接続された回路構成が採用されている。

【００２０】

このような回路構成においては、駆動電流制御手段となる薄膜トランジスタがオン、オフ動作することにより（スイッチング制御されることにより）、発光素子に印加される電圧が相対的に変動する現象が生じる。具体的には後述するが、例えば上述した電流指定型の階調制御方法において、駆動電流制御手段のスイッチング制御に伴って、薄膜トランジスタに印加される制御電圧（ゲート電圧）が変化するとともに、薄膜トランジスタの電流路の両端に印加される電圧が変化することにより、書込動作における階調電流（書込電流）の指定電流値に対して、発光素子に供給される発光駆動電流の出力電流値に差異が生じるため、表示データに応じた適切な輝度階調で発光素子を発光動作させることができなくなり、コントラストの低下等を生じて表示画質の劣化を招くという問題を有していた。

40

【００２１】

そこで、本発明は、上述した問題点に鑑み、表示パネルに２次元配列された表示画素（画素駆動回路）の駆動時に生じる電圧変化に起因して生じる書込電流（指定電流）と発光駆動電流（出力電流）の差異を抑制して、表示データに応じた適切な輝度階調で発光素子

50

を発光動作させることができる画素駆動回路、及び、表示画質の劣化を抑制することができる画像表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0022】

請求項1記載の発明は、表示画素に設けられた電流制御型の発光素子に対して、階調信号に応じた電流値を有する発光駆動電流を供給して、前記階調信号に基づく所定の輝度階調で発光動作させる画素駆動回路において、少なくとも、前記階調信号に基づく電荷を電圧成分として保持する電荷保持手段と、該電荷保持手段に保持された電圧成分に基づいて、前記発光駆動電流を生成して、前記発光素子に供給する駆動電流制御手段と、を備え、前記駆動電流制御手段は、半導体層を挟んで対向して設けられた第1のゲート電極及び第2のゲート電極と、前記半導体層の両端部に設けられたソース電極及びドレイン電極と、を具備するダブルゲート型の薄膜トランジスタ構造を有し、前記ソース電極が前記発光素子の一端に接続され、前記第1のゲート電極が前記ソース電極の電位と同一になるように設定されていることを特徴とする。

10

【0023】

請求項2記載の発明は、請求項1記載の画素駆動回路において、前記駆動電流制御手段は、前記第1のゲート電極と前記ソース電極が電氣的に接続されていることを特徴とする。

請求項3記載の発明は、請求項1又は2記載の画素駆動回路において、前記発光素子は、画素電極と、該画素電極上に設けられた発光層と、前記発光層を介して前記画素電極に対向するように設けられた対向電極とを備え、前記駆動電流制御手段は、前記第1のゲート電極と前記ソース電極が前記画素電極に電氣的に接続されていることを特徴とする。

20

【0024】

請求項4記載の発明は、請求項3記載の画素駆動回路において、前記駆動電流制御手段は、前記第1のゲート電極が前記画素電極と一体的に形成されていることを特徴とする。

請求項5記載の発明は、請求項3又は4記載の画素駆動回路において、前記発光素子は、前記画素電極が光透過特性を有する電極材料により形成されていることを特徴とする。

【0025】

請求項6記載の発明は、請求項3又は4記載の画素駆動回路において、前記発光素子は、前記画素電極が光反射特性を有する電極材料により形成されていることを特徴とする。

30

請求項7記載の発明は、請求項1乃至6のいずれかに記載の画素駆動回路において、前記駆動電流制御手段は、前記ソース電極及び前記ドレイン電極が前記半導体層上に延在するように設けられていることを特徴とする。

【0026】

請求項8記載の発明は、請求項7記載の画素駆動回路において、前記駆動電流制御手段は、前記半導体層上にブロック絶縁膜を有し、前記ソース電極及び前記ドレイン電極が前記ブロック絶縁膜上に延在するように設けられていることを特徴とする。

請求項9記載の発明は、請求項1乃至8のいずれかに記載の画素駆動回路において、前記画素駆動回路は、前記階調信号を前記電荷保持手段に供給するタイミングを制御する階調信号制御手段を備えていることを特徴とする。

40

【0027】

請求項10記載の発明は、請求項9記載の画素駆動回路において、前記階調信号制御手段は、ダブルゲート型の薄膜トランジスタ構造を有し、半導体層の上方に設けられたゲート電極が遮光性の電極材料により形成されていることを特徴とする。

請求項11記載の発明は、請求項1又は10記載の画素駆動回路において、前記ダブルゲート型の薄膜トランジスタは、前記半導体層がアモルファスシリコンからなることを特徴とする。

請求項12記載の発明は、請求項1乃至11のいずれかに記載の画素駆動回路において、前記階調信号は、前記輝度階調に応じた電流値を有する信号電流であることを特徴とする。

50

【 0 0 2 8 】

請求項 1 3 記載の発明は、表示パネルに互いに直行するように配設された複数の走査ライン及び複数の信号ラインの各交点近傍に配置された複数の表示画素に対して、前記各信号ラインを介して、表示データに応じた階調信号を供給することにより、前記表示パネルに所望の画像情報を表示する画像表示装置において、前記各表示画素は、電流制御型の発光素子と、前記発光素子の発光動作を制御する画素駆動回路と、を備え、前記画素駆動回路は、少なくとも、前記階調信号に基づく電荷を電圧成分として保持する電荷保持手段と、該電荷保持手段に保持された電圧成分に基づいて、前記発光駆動電流を生成して、前記発光素子に供給する駆動電流制御手段と、前記階調信号を前記電荷保持手段に供給するタイミングを制御する階調信号制御手段と、を備え、前記駆動電流制御手段は、半導体層を挟んで対向して設けられた第 1 のゲート電極及び第 2 のゲート電極と、前記半導体層の両端部に設けられたソース電極及びドレイン電極と、を具備するダブルゲート型の薄膜トランジスタ構造を有し、前記ソース電極が前記発光素子の一端に接続され、前記第 1 のゲート電極が前記ソース電極の電位と同一になるように設定されていることを特徴とする。

10

【 0 0 2 9 】

請求項 1 4 記載の発明は、請求項 1 3 記載の画像表示装置において、前記画像表示装置は、少なくとも、前記走査ラインに選択信号を印加して、前記走査ラインに接続された前記表示画素に設けられた前記階調信号制御手段により、前記階調信号の当該表示画素への書き込みを可能とする選択状態に設定する走査駆動手段と、前記選択状態に設定された前記表示画素に対応した前記表示データに基づく前記階調信号を生成して、前記信号ライン

20

【 0 0 3 0 】

請求項 1 5 記載の発明は、請求項 1 4 記載の画像表示装置において、前記信号駆動手段から供給される前記階調信号は、前記表示データに応じた電流値を有する信号電流であることを特徴とする。

請求項 1 6 記載の発明は、請求項 1 3 乃至 1 5 のいずれかに記載の画像表示装置において、前記画素駆動回路に設けられる前記駆動電流制御手段は、前記第 1 のゲート電極と前記ソース電極が電氣的に接続されていることを特徴とする。

【 0 0 3 1 】

請求項 1 7 記載の発明は、請求項 1 5 又は 1 6 記載の画像表示装置において、前記発光素子は、画素電極と、該画素電極上に設けられた発光層と、前記発光層を介して前記画素電極に対向するように設けられた対向電極とを備え、前記画素駆動回路に設けられる前記駆動電流制御手段は、前記第 1 のゲート電極と前記ソース電極が前記画素電極に電氣的に接続されていることを特徴とする。

30

【 0 0 3 2 】

請求項 1 8 記載の発明は、請求項 1 7 記載の画像表示装置において、前記画素駆動回路に設けられる前記駆動電流制御手段は、前記第 1 のゲート電極が前記画素電極と一体的に形成されていることを特徴とする。

請求項 1 9 記載の発明は、請求項 1 3 乃至 1 8 のいずれかに記載の画像表示装置において、前記発光素子は、有機エレクトロルミネッセント素子であることを特徴とする。

40

【 発明の効果 】

【 0 0 3 3 】

本発明に係る画素駆動回路及び画像表示装置によれば、表示パネルに 2 次元配列された表示画素（画素駆動回路）の駆動時に生じる電圧変化に起因して生じる書込電流（指定電流）と発光駆動電流（出力電流）の差異を抑制して、表示データに応じた適切な輝度階調で発光素子を発光動作させることができ、表示画質の劣化を抑制することができる。

【 発明を実施するための最良の形態 】

【 0 0 3 4 】

以下に、本発明に係る画素駆動回路及び該画素駆動回路を含む表示画素が 2 次元配列された表示パネルを備えた画像表示装置について、実施の形態を示して詳しく説明する。

50

< 画像表示装置 >

まず、本発明に係る画像表示装置の概略構成について、図面を参照して説明する。

図１は、本発明に係る画像表示装置の一実施形態を示す概略ブロック図である。ここでは、電流指定型の階調制御方法に対応した構成を有する画像表示装置について説明する。

【 0 0 3 5 】

図１に示すように、本発明に係る画像表示装置１００は、概略、行方向（図面左右方向）に配設された複数の走査ラインＳＬと列方向（図面上下方向）に配設された複数のデータライン（信号ライン）ＤＬとの各交点近傍に、複数の表示画素ＥＭがｎ行×ｍ列（ｎ、ｍは、任意の正の整数）のマトリクス状に配列された表示パネル１１０と、各走査ラインＳＬに所定のタイミングで順次走査信号（選択信号）Ｖselを印加することにより、行ごとの表示画素ＥＭを選択状態に設定（走査）する走査ドライバ（走査駆動手段）１２０と、走査ラインＳＬに並行して行方向に配設された複数の電源電圧ラインＶＬに所定のタイミングで所定の電圧レベルの電源電圧Ｖscを印加する電源ドライバ（電源駆動手段）１３０と、表示データに基づく電流値が指定された階調電流（階調信号、信号電流）Ｉpixを生成して、各データラインＤＬに供給するデータドライバ（信号駆動手段）１４０と、後述する表示信号生成回路１６０から供給されるタイミング信号に基づいて、少なくとも走査ドライバ１２０、電源ドライバ１３０及びデータドライバ１４０の動作状態を制御するための走査制御信号、電源制御信号及びデータ制御信号を生成して出力するシステムコントローラ１５０と、例えば画像表示装置１００の外部から供給される映像信号に基づいて、デジタル信号からなる表示データ（輝度階調データ）を生成し、上記データドライバ１４０に供給するとともに、該表示データに基づいて表示パネル１１０に所定の画像情報を表示するためのタイミング信号（システムクロック等）を抽出、又は、生成して上記システムコントローラ１５０に供給する表示信号生成回路１６０と、を備えている。

【 0 0 3 6 】

（表示パネル１１０）

表示パネル１１０にマトリクス状に２次元配列された各表示画素ＥＭは、例えば有機ＥＬ素子等の電流制御型の発光素子と、走査ドライバ１２０から走査ラインＳＬに印加される走査信号Ｖsel、電源ドライバ１３０から電源電圧ラインＶＬに印加される電源電圧Ｖsc、及び、データドライバ１４０からデータラインＤＬに供給される階調電流Ｉpixに基づいて、該階調電流Ｉpixに応じた電圧成分を保持する書込動作、及び、該電圧成分に基づいて、所定の電流値を有する発光駆動電流を上記発光素子に供給して所定の輝度階調で発光させる発光動作を、選択的に実行する画素駆動回路と、を有している。なお、本発明に適用可能な表示画素（画素駆動回路及び発光素子）の具体例については後述する。

【 0 0 3 7 】

（走査ドライバ１２０）

走査ドライバ１２０は、システムコントローラ１５０から供給される走査制御信号に基づいて、各走査ラインＳＬに選択レベル（例えば、ハイレベル）の走査信号Ｖselを順次印加することにより、各行ごとの表示画素ＥＭを選択状態に設定し、データドライバ１４０により各データラインＤＬを介して供給される、表示データに基づく階調電流Ｉpixを、各表示画素ＥＭ（画素駆動回路）に書き込むように制御する。

【 0 0 3 8 】

ここで、走査ドライバ１２０は、例えば、後述するシステムコントローラ１５０から供給される走査制御信号に基づいて、各行の走査ラインＳＬに対応するシフト信号を順次出力するシフトレジスタと、該シフト信号を所定の電圧レベル（選択レベル）に変換して、各行の走査ラインＳＬに走査信号Ｖselとして順次出力する出力回路部（出力バッファ）と、を備えたものを適用することができる。

【 0 0 3 9 】

（電源ドライバ１３０）

電源ドライバ１３０は、システムコントローラ１５０から供給される電源制御信号に基づいて、各電源電圧ラインＶＬに、後述する書込動作期間においては、ローレベルの電源

10

20

30

40

50

電圧 V_{sc} ($= V_{scw}$) を印加することにより、データドライバ 140 により供給される階調電流 I_{pix} が表示画素 EM (画素駆動回路) に書き込まれるように制御し、発光動作期間中においては、ハイレベルの電源電圧 V_{sc} ($= V_{sce}$) を印加することにより、表示データ (階調電流 I_{pix}) に応じた電流値を有する発光駆動電流が発光素子に供給されるように制御する。

【0040】

ここで、電源ドライバ 130 は、例えば、システムコントローラ 150 から供給される電源制御信号に基づいて、各行の電源電圧ライン VL に対応するシフト信号を順次出力するシフトレジスタと、該シフト信号を所定の電圧レベルに変換して、各行の電源電圧ライン VL に電源電圧 V_{sc} として出力する出力回路部 (出力バッファ) と、を備えたものを適用することができる。

10

【0041】

(データドライバ 140)

データドライバ 140 は、システムコントローラ 150 から供給されるデータ制御信号に基づいて、表示信号生成回路 160 から供給される各表示画素 EM ごとの表示データを所定のタイミングで取り込んで保持し、該表示データの階調値に応じた電流値を有する階調電流 I_{pix} を生成して、上記各走査ライン SL ごとに設定される選択期間内に各データライン DL に供給する。

【0042】

ここで、データドライバ 140 は、例えば、システムコントローラ 150 から供給されるデータ制御信号に基づいて、順次シフト信号を出力するシフトレジスタと、該シフト信号の入力タイミングに基づいて、表示信号生成回路 160 から供給される 1 行分の表示データを順次取り込むデータレジスタと、取り込まれた 1 行分の表示データを保持するデータラッチ回路と、階調基準電圧に基づいて、上記保持された表示データを所定のアナログ信号電圧に変換する D/A コンバータ (デジタル - アナログ変換器) と、アナログ信号電圧に対応する電流値を有する階調電流 I_{pix} を生成し、データライン DL を介して各表示画素 EM に供給する電圧電流変換・電流供給回路と、を備えたものを適用することができる。

20

【0043】

(システムコントローラ 150)

システムコントローラ 150 は、例えば、表示信号生成回路 160 から供給されるタイミング信号に基づいて、少なくとも走査ドライバ 120、電源ドライバ 130 及びデータドライバ 140 に対して、動作状態を制御する走査制御信号、電源制御信号及びデータ制御信号を生成して出力することにより、各ドライバを所定のタイミングで動作させて、走査信号 V_{sel} 、電源電圧 V_{sc} 及び階調電流 I_{pix} を生成させ、各走査ライン SL 、電源電圧ライン VL 及びデータライン DL に印加して各表示画素 (画素駆動回路及び発光素子) EM における一連の駆動制御動作 (書込動作及び発光動作) を実行させて、映像信号に基づく画像情報を表示パネル 110 に表示させる制御を行う。

30

【0044】

(表示信号生成回路 160)

表示信号生成回路 160 は、例えば画像表示装置 100 の外部から供給される映像信号から輝度階調信号成分を抽出して、表示パネル 110 の 1 行分ごとに、該輝度階調信号成分をデジタル信号からなる表示データ (輝度階調データ) としてデータドライバ 140 に供給する。ここで、上記映像信号が、例えばテレビ放送信号 (コンポジット映像信号) のように、画像情報の表示タイミングを規定するタイミング信号成分を含む場合には、表示信号生成回路 160 は、図 1 に示すように、上記輝度階調信号成分を抽出する機能のほかに、タイミング信号成分を抽出してシステムコントローラ 150 に供給する機能を有するものであってもよい。この場合においては、上記システムコントローラ 150 は、表示信号生成回路 160 から供給されるタイミング信号に基づいて、走査ドライバ 120 や電源ドライバ 130、データドライバ 140 に対して個別に供給する各制御信号を生成する。

40

50

【 0 0 4 5 】

なお、画像表示装置 1 0 0 の外部から供給される映像信号がデジタル信号により形成され、また、タイミング信号が映像信号とは別に供給されている場合には、当該映像信号（デジタル信号）をそのまま表示データとして、データドライバ 1 4 0 に供給するとともに、当該タイミング信号を直接システムコントローラ 1 5 0 に供給するようにして、表示信号生成回路 1 6 0 を省略するようにしてもよい。

【 0 0 4 6 】

< 表示画素 >

次いで、上述した画像表示装置に適用される表示パネルに 2 次元配列される表示画素の具体回路例について、図面を参照して詳しく説明する。

図 2 は、本実施形態に係る表示装置に適用可能な表示画素（画素駆動回路）の具体回路例を示す回路構成図であり、図 3 は、本実施形態に係る画素駆動回路に適用可能なダブルゲート型トランジスタの素子構造の例を示す断面構成図である。

【 0 0 4 7 】

本実施形態に係る表示画素 E M は、図 2 に示すように、上述した表示パネル 1 1 0 に相互に直交するように配設された走査ライン S L とデータライン D L との各交点近傍に、例えば、ゲート端子が走査ライン S L に、ドレイン端子が電源電圧ライン V L に、ソース端子が接点 N 1 1 に各々接続されたトランジスタ（階調信号制御手段）T r 1 1 と、ゲート端子が走査ライン S L に、ドレイン端子がデータライン D L に、ソース端子が接点 N 1 2 に各々接続されたトランジスタ（階調信号制御手段）T r 1 2 と、ボトムゲート端子 B G が接点 N 1 1 に、ドレイン端子 D が電源電圧ライン V L に、トップゲート端子 T G 及びソース端子 S が接点 N 1 2 に各々接続されたダブルゲート型のトランジスタ（ダブルゲート型トランジスタ；駆動電流制御手段）T r 1 3 と、接点 N 1 1 と接点 N 1 2 の間（すなわち、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 のボトムゲート - ソース間）に接続されたキャパシタ（電荷保持手段）C s と、を備えた画素駆動回路 D C、及び、アノード端子が上記画素駆動回路 D C の接点 N 1 2 に接続され、カソード端子が所定の低電圧（例えば接地電位 G N D）に接続された有機 E L 素子（電流制御型の発光素子）O L E D を有している。

【 0 0 4 8 】

ここで、有機 E L 素子 O L E D に直列に接続され、発光駆動用のスイッチング素子として機能するダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 の第 1 の素子構造の例は、例えば図 3（a）に示すように、アモルファスシリコンやポリシリコン等からなる n チャネル型の半導体層（チャネル領域）S M C と、半導体層 S M C の両端に、各々 n⁺シリコンからなる不純物層（オーミックコンタクト層）O H M を介して形成されたソース電極 T r 1 3 s（ソース端子 S）及びドレイン電極 T r 1 3 d（ドレイン端子 D）と、半導体層 S M C の上方（図面上方）に絶縁膜（トップゲート絶縁膜）1 3 を介して形成されたトップゲート電極 T r 1 3 t g（トップゲート端子 T G、後述する画素電極 1 4 と一体的に形成される；第 1 のゲート電極）と、半導体層 S M C の下方（図面下方）に絶縁膜（ボトムゲート絶縁膜）1 2 を介して形成されたボトムゲート電極 T r 1 3 b g（ボトムゲート端子 B G；第 2 のゲート電極）と、を有して構成されている。

【 0 0 4 9 】

また、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 の第 2 の素子構造の例は、例えば図 3（b）に示すように、上述した第 1 の素子構造（図 3（a））に加え、半導体層 S M C 上にブロック絶縁膜（エッチングストップ膜）B L が設けられ、半導体層 S M C の上方（図面上方）に該ブロック絶縁膜 B L 及び絶縁膜 1 3 を介してトップゲート電極 T r 1 3 t g（後述する画素電極 1 4 と一体的に形成される）が形成されている。ここで、ブロック絶縁膜 B L は、半導体層 S M C 上に設けられるソース電極 T r 1 3 s 及びドレイン電極 T r 1 3 d をパターンニング形成する際のエッチング工程において、エッチングストップとしての機能を有するとともに、当該エッチングによる半導体層 S M C へのダメージを防止するための機能を有するものである。

【 0 0 5 0 】

このような構成を有するダブルゲート型トランジスタ $Tr13$ は、図3(a)、(b)に示すように、ガラス基板等の絶縁性基板11上に形成されている。また、少なくとも該ダブルゲート型トランジスタ $Tr13$ のトップゲート電極 $Tr13tg$ 上には絶縁膜15が被覆形成されている。

【0051】

そして、本発明においては、このような構成を有するダブルゲート型トランジスタ $Tr13$ において、例えば、トップゲート電極 $Tr13tg$ （画素電極14）とソース電極 $Tr13s$ が電氣的に接続（短絡）され、同電位になるように構成されている。詳しくは後述するが、この場合、例えば、図3(a)、(b)に示した素子構造において、トップゲート絶縁膜となる絶縁膜13に形成されたコンタクトホールを介して、上層側のトップゲート電極 $Tr13tg$ （画素電極14）と下層側のソース電極 $Tr13s$ とが電氣的に接続された構成を適用することができる。

10

【0052】

また、トランジスタ $Tr11$ 、 $Tr12$ は、周知の電界効果型のトランジスタ（薄膜トランジスタ）を適用することができる。また、キャパシタ Cs は、ダブルゲート型トランジスタ $Tr13$ のボトムゲート・ソース間に形成される寄生容量であってもよいし、該寄生容量に加えて接点 $N11$ 及び接点 $N12$ 間にさらに容量素子を並列に接続したものであってもよい。

【0053】

なお、本実施形態に係る画素駆動回路 DC に適用されるトランジスタ $Tr11 \sim Tr13$ については、特に限定するものではないが、以下の説明においては、いずれのトランジスタも n チャネル型の半導体層をチャネル領域として備えたトランジスタ構造を適用した場合について説明する。

20

【0054】

次いで、上述したような回路構成を有する表示画素（画素駆動回路及び発光素子）の具体的なデバイス構造（平面レイアウト及び断面構造）について説明する。

図4は、本実施形態に係る表示装置（表示パネル）に適用可能な表示画素の一例を示す平面レイアウト図であり、図5は、図4に示した平面レイアウトを有する表示画素におけるA-A断面を示す概略断面図である。なお、図4においては、表示画素 EM （画素駆動回路）の素子構造を明確にするために、画素駆動回路の各トランジスタ及び配線層等が形成された層を中心に示す。

30

【0055】

表示画素 EM は、例えば図4に示すように、絶縁性基板11の一面側に設定された表示画素の形成領域（画素形成領域） Rpx において、上方及び下方の縁辺領域の X 方向（図4の左右方向；図1における行方向に対応する）に延在するように走査ライン SL 及び電源電圧ライン VL が各々配設されるとともに、これらに直交するように、上記画素形成領域 Rpx の左方の縁辺領域の Y 方向（図4の上下方向；図1における列方向に対応する）に延在するようにデータライン DL 及び BL が配設されている。また、図2に示したトランジスタ $Tr11$ 及びトランジスタ $Tr12$ は、データライン DL に沿って Y 方向に延在するように配置され、トランジスタ $Tr13$ は、画素形成領域 Rpx の右方の縁辺領域の Y 方向に延在するように配置されている。

40

【0056】

ここで、上述したように、トランジスタ $Tr11$ 、 $Tr12$ は、周知の電界効果型トランジスタ構造を有し、図5においてはトランジスタ $Tr12$ のみを示すが、各々、ガラス基板等の透明な絶縁性基板11上に形成されたゲート電極 $Tr11g$ 、 $Tr12g$ と、ゲート絶縁膜12を介して各ゲート電極 $Tr11g$ 、 $Tr12g$ に対応する領域に形成された半導体層 SMC と、該半導体層 SMC の両端部に延在するように形成されたソース電極 $Tr11s$ 、 $Tr12s$ 及びドレイン電極 $Tr11d$ 、 $Tr12d$ と、を有している。

【0057】

また、トランジスタ $Tr13$ は、図3(a)、(b)に示したような素子構造を有し、

50

図 5 に示すように、絶縁性基板 1 1 上に形成されたボトムゲート電極 $Tr\ 1\ 3\ b\ g$ と、ゲート絶縁膜 1 2 を介してボトムゲート電極 $Tr\ 1\ 3\ b\ g$ に対応する領域に形成された半導体層 $S\ M\ C$ と、該半導体層 $S\ M\ C$ の両端部に延在するように形成されたソース電極 $Tr\ 1\ 3\ s$ 及びドレイン電極 $Tr\ 1\ 3\ d$ と、絶縁膜 1 3 を介して半導体層 $S\ M\ C$ に対応する領域に形成されたトップゲート電極 $Tr\ 1\ 3\ t\ g$ と、を有している。

【 0 0 5 8 】

なお、図 5 においては図示を簡略化して示したが、各トランジスタ $Tr\ 1\ 1$ 、 $Tr\ 1\ 2$ 及びダブルゲート型トランジスタ $Tr\ 1\ 3$ のソース電極とドレイン電極が対向する半導体層 $S\ M\ C$ 上には当該半導体層 $S\ M\ C$ へのエッチングダメージを防止するための酸化シリコン又は窒化シリコン等のブロッキング層が形成され、また、ソース電極とドレイン電極が接触する半導体層 $S\ M\ C$ 上には、当該半導体層 $S\ M\ C$ とソース電極及びドレイン電極とのオーミック接続を実現するための不純物層が形成されているものであってもよい（ダブルゲート型トランジスタ $Tr\ 1\ 3$ においては、図 3（b）に示した素子構造に対応する）。

【 0 0 5 9 】

ここで、トランジスタ $Tr\ 1\ 1$ 、 $Tr\ 1\ 2$ のゲート電極 $Tr\ 1\ 1\ g$ 、 $Tr\ 1\ 2\ g$ 、及び、ダブルゲート型トランジスタ $Tr\ 1\ 3$ のボトムゲート電極 $Tr\ 1\ 3\ b\ g$ 、並びに、データライン $D\ L$ は、いずれも同一のゲートメタル層をパターニングすることによって形成されている。また、トランジスタ $Tr\ 1\ 1$ 、 $Tr\ 1\ 2$ のソース電極 $Tr\ 1\ 1\ s$ 、 $Tr\ 1\ 2\ s$ 及びドレイン電極 $Tr\ 1\ 1\ d$ 、 $Tr\ 1\ 2\ d$ 、ダブルゲート型トランジスタ $Tr\ 1\ 3$ のソース電極 $Tr\ 1\ 3\ s$ 及びドレイン電極 $Tr\ 1\ 3\ d$ 、並びに、走査ライン $S\ L$ 、電源電圧ライン $V\ L$ は、いずれも同一のソース、ドレインメタル層をパターニングすることによって形成されている。また、ダブルゲート型トランジスタ $Tr\ 1\ 3$ のトップゲート電極 $Tr\ 1\ 3\ t\ g$ 及び後述する有機 $E\ L$ 素子 $O\ L\ E\ D$ の画素電極（例えばアノード電極）1 4 は、同一の電極材料により一体的に形成されている。さらに、図 4、図 5 に示すように、電源電圧ライン $V\ L$ は、ダブルゲート型トランジスタ $Tr\ 1\ 3$ のドレイン電極 $Tr\ 1\ 3\ d$ と一体的に形成され、走査ライン $S\ L$ 及び電源電圧ライン $V\ L$ は、データライン $D\ L$ よりも上層側に設けられている。

【 0 0 6 0 】

そして、図 2 に示した画素駆動回路 $D\ C$ の回路構成に対応するように、トランジスタ $Tr\ 1\ 1$ は、例えば図 4、図 5 に示すように、ゲート電極 $Tr\ 1\ 1\ g$ がゲート絶縁膜 1 2 に設けられたコンタクトホール $H\ L\ A$ を介して走査ライン $S\ L$ に接続され、同ソース電極 $Tr\ 1\ 1\ s$ がゲート絶縁膜 1 2 に設けられたコンタクトホール $H\ L\ B$ を介してキャパシタ $C\ s$ の一端側（接点 $N\ 1\ 1$ 側）の電極 $E\ C\ A$ に接続され、同ドレイン電極 $Tr\ 1\ 1\ d$ が電源電圧ライン $V\ L$ と一体的に形成されている。

【 0 0 6 1 】

また、トランジスタ $Tr\ 1\ 2$ は、例えば図 4、図 5 に示すように、ゲート電極 $Tr\ 1\ 2\ g$ がゲート絶縁膜 1 2 に設けられたコンタクトホール $H\ L\ A$ を介して走査ライン $S\ L$ に接続され、同ソース電極 $Tr\ 1\ 2\ s$ がキャパシタ $C\ s$ の他端側（接点 $N\ 1\ 2$ 側）の電極 $E\ C\ B$ と一体的に形成され、同ドレイン電極 $Tr\ 1\ 2\ d$ がゲート絶縁膜 1 2 に設けられたコンタクトホール $H\ L\ C$ を介してデータライン $D\ L$ に接続されている。

【 0 0 6 2 】

ダブルゲート型トランジスタ $Tr\ 1\ 3$ は、例えば図 4、図 5 に示すように、ボトムゲート電極 $Tr\ 1\ 3\ b\ g$ がキャパシタ $C\ s$ の一端側（接点 $N\ 1\ 1$ 側）の電極 $E\ C\ A$ と一体的に形成され、同ソース電極 $Tr\ 1\ 3\ s$ がキャパシタ $C\ s$ の他端側（接点 $N\ 1\ 2$ 側）の電極 $E\ C\ B$ と一体的に形成され、同ドレイン電極 $Tr\ 1\ 3\ d$ が電源電圧ライン $V\ L$ と一体的に形成され、トップゲート電極 $Tr\ 1\ 3\ t\ g$ が有機 $E\ L$ 素子 $O\ L\ E\ D$ の画素電極 1 4 と一体的に形成されるとともに、絶縁膜 1 3 に設けられたコンタクトホール $H\ L\ D$ を介して上記ソース電極 $Tr\ 1\ 3\ s$ に接続されている。

【 0 0 6 3 】

また、キャパシタ $C\ s$ は、ダブルゲート型トランジスタ $Tr\ 1\ 3$ のボトムゲート電極 T

10

20

30

40

50

r 1 3 b g と一体的に形成されるとともに、トランジスタ T r 1 1 のソース電極 T r 1 1 s に接続された一端側の電極 E C A と、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 のソース電極 T r 1 3 s 及びトランジスタ T r 1 2 のソース電極 T r 1 2 s と一体的に形成された他端側の電極 E C B と、ゲート絶縁膜 1 2 を介して対向するように延在して形成されている。

【 0 0 6 4 】

そして、画素形成領域 Rpx のうち、有機 E L 素子 O L E D の形成領域には、上述したダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 のトップゲート電極 T r 1 3 t g と一体的に形成された画素電極（例えばアノード電極）1 4、正孔輸送層 1 6 a（電荷輸送層）及び電子輸送性発光層 1 6 b（電荷輸送層）からなる有機 E L 層（発光層）1 6、及び、対向電極（例えばカソード電極）1 7 を順次積層した有機 E L 素子 O L E D が設けられ、一方、有機 E L 素子 O L E D の形成領域以外の領域には、上述したトランジスタ T r、T r 1 2 及びダブルゲート型トランジスタ T r 1 3、走査ライン S L、電源電圧ライン V L、データライン D L 上に層間絶縁膜 1 5 が被覆形成され、当該層間絶縁膜 1 5 上に、上記対向電極 1 7 が延在するように形成されている。

10

【 0 0 6 5 】

すなわち、対向電極 1 7 は、絶縁性基板 1 1 上に 2 次元配列された複数の表示画素 E M（各画素電極 1 4）に対して共通に対向するように単一の平面電極（べた電極）により形成されている。そして、上記画素駆動回路 D C、有機 E L 素子 O L E D が形成された絶縁性基板 1 1 の全域には、例えば図 5 に示すように、絶縁性の封止層 1 8 が被覆形成されている。

20

【 0 0 6 6 】

ここで、表示パネル 1 1 0（表示画素 E M）がボトムエミッション構造の場合、画素電極 1 4 が例えば錫ドープ酸化インジウム（Indium Thin Oxide；I T O）や亜鉛ドープ酸化インジウム（Indium Zinc Oxide；I Z O）等の透明な（光透過特性を有する）電極材料により形成され、対向電極 1 7 が例えばアルミニウム（A l）、クロム（C r）、銀（A g）、パラジウム銀（A g P d）系の合金等の光反射特性を有する電極材料により形成されることにより、有機 E L 層 1 6 において発光した光が絶縁性基板 1 1 を介して視野側である絶縁性基板 1 1 の他面側（図 5 の図面下方）に出射され、一方、表示パネル 1 1 0（表示画素 E M）がトップエミッション構造の場合、画素電極 1 4 が光反射特性を有し、対向電極 1 7 が光透過特性を有する電極材料により形成されることにより、有機 E L 層 1 6 において発光した光が封止層 1 8 を介して絶縁性基板 1 1 の一面側（図 5 の図面上方）に出射される。

30

【 0 0 6 7 】

なお、表示パネル 1 1 0 に配列される発光素子として、高分子系の有機材料を塗布して形成される有機 E L 層を備えた有機 E L 素子を適用した場合においては、上述した有機 E L 素子 O L E D の形成領域（すなわち、有機 E L 層 1 6 となる正孔輸送層 1 6 a 及び電子輸送性発光層 1 6 b を塗布形成する領域）を画定するために、有機 E L 素子 O L E D の形成領域間の各配線層やトランジスタ上に形成される層間絶縁膜 1 5 を、絶縁性基板 1 1 表面から突出するように隔壁状又はバンク状に形成するものであってもよい。

40

【 0 0 6 8 】

図 6 は、本実施形態に係る画素駆動回路を適用した表示画素の基本動作を示すタイミングチャートであり、図 7 は、本実施形態に係る画素駆動回路の動作状態を示す概念図である。ここで、図 6 においては、表示パネル 1 1 0 の i 行 j 列、及び、(i + 1) 行 j 列（i は 1 i n となる正の整数、j は 1 j m となる正の整数）の表示画素 E M における駆動制御動作を示す。

【 0 0 6 9 】

このような構成を有する画素駆動回路 D C における発光素子（有機 E L 素子 O L E D）の発光駆動制御（駆動制御方法）は、例えば、図 6 に示すように、一走査期間 T sc を 1 サイクルとして、該一走査期間 T sc 内に、走査ライン S L に接続された表示画素 E M を選択

50

して表示データに応じた階調電流 I_{pix} を流して、表示データに応じた電圧成分を保持させる書込動作期間（選択期間） T_{se} と、該書込動作期間 T_{se} に保持された電圧成分に基づいて、上記表示データに応じた発光駆動電流を生成して有機 EL 素子 OLED に供給し、所定の輝度階調で発光動作させる発光動作期間（非選択期間） T_{nse} と、を含むように設定することにより実行される（ $T_{sc} = T_{se} + T_{nse}$ ）。ここで、各行の走査ライン SL ごとに設定される書込動作期間 T_{se} は、相互に時間的な重なりが生じないように設定される。

【0070】

（書込動作期間）

表示画素 EM の書込動作期間 T_{se} においては、図 6 に示すように、まず、走査ドライバ 120 から特定の走査ライン（例えば、 i 行目の走査ライン）SL に対して、ハイレベルの走査信号 V_{sel} が印加されて当該行の表示画素 EM が選択状態に設定されるとともに、電源ドライバ 130 から当該行の表示画素 EM の電源電圧ライン VL に対して、ローレベルの電源電圧 V_{sc} （ $= V_{scw}$ ）が印加される。また、このタイミングに同期して、データドライバ 140 により当該行の各表示画素 EM に対応する表示データに基づいた電流値を有する階調電流 I_{pix} を各データライン DL から引き込む。

10

【0071】

これにより、画素駆動回路 DC を構成するトランジスタ Tr_{11} 、 Tr_{12} がオン動作して、ローレベルの電源電圧 V_{sc} が接点 N11（すなわち、ダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} のボトムゲート端子 BG 及びキャパシタ Cs の一端側）に印加されるとともに、データドライバ 140 によりデータライン DL 側から階調電流 I_{pix} を引き込む動作が行われることにより、ローレベルの電源電圧 V_{sc} よりも低電位の電圧レベルが接点 N12（すなわち、ダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} のソース端子 S、及び、キャパシタ Cs の他端）に印加される。

20

【0072】

このように、接点 N11 及び N12 間（ダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} のボトムゲート - ソース間）に電位差が生じることにより、ダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} がオン動作して、図 7（a）に示すように、電源電圧ライン VL からダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} 、接点 N12、トランジスタ Tr_{12} 、データライン DL を介して、データドライバ 140 に、階調電流 I_{pix} の電流値に対応した書込電流（指定電流） I_a が流れる。

30

【0073】

このとき、キャパシタ Cs には、接点 N11 及び N12 間（ダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} のボトムゲート - ソース間）に生じた電位差に対応する電荷が蓄積され、電圧成分として保持される（充電される）。また、電源電圧ライン VL には、接地電位以下の電圧レベルを有するローレベルの電源電圧 V_{sc} （ $= V_{scw}$ ）が印加され、さらに、書込電流 I_a がデータライン DL 方向に流れるように制御されることから、有機 EL 素子 OLED のアノード端子（接点 N12）に印加される電位はカソード端子の電位（接地電位 GND）よりも低くなり、有機 EL 素子 OLED に逆バイアス電圧が印加されることになるため、有機 EL 素子 OLED には発光駆動電流が流れず、発光動作は行われない。

40

【0074】

（発光動作期間）

次いで、書込動作期間 T_{se} 終了後の発光動作期間 T_{nse} においては、図 6 に示すように、走査ドライバ 120 から上記書込動作が行われた走査ライン SL に対して、ローレベルの走査信号 V_{sel} が印加されて表示画素 EM が非選択状態に設定されるとともに、当該行の表示画素 EM の電源電圧ライン VL に対して、ハイレベルの電源電圧 V_{sc} （ $= V_{sce}$ ）が印加される。また、このタイミングに同期して、データドライバ 140 による階調電流 I_{pix} の引き込み動作が停止される。

【0075】

これにより、画素駆動回路 DC を構成するトランジスタ Tr_{11} 及び Tr_{12} がオフ動

50

作して、接点 N 1 1 (すなわち、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 のボトムゲート端子 B G 及びキャパシタ C s の一端側) への電源電圧 V s c の印加が遮断されるとともに、接点 N 1 2 (すなわち、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 のソース端子 S 及びキャパシタ C s の他端側) へのデータドライバ 1 4 0 による階調電流 I p i x の引き込み動作に起因する電圧レベルの印加が遮断されるので、キャパシタ C s は、上述した書込動作期間において蓄積された電荷を保持する。

【 0 0 7 6 】

このように、キャパシタ C s が書込動作時の充電電圧を保持することにより、接点 N 1 1 及び N 1 2 間 (ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 のボトムゲート - ソース間) の電位差が保持されることになり、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 はオン状態を維持する。また、電源電圧ライン V L には、接地電位よりも高い電圧レベルを有するハイレベルの電源電圧 V s c (= V s c e) が印加されるので、有機 E L 素子 O L E D のアノード端子 (接点 N 1 2) に印加される電位はカソード端子の電位 (接地電位) よりも高くなる。

10

【 0 0 7 7 】

したがって、図 7 (b) に示すように、電源電圧ライン V L からダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 、接点 N 1 2 を介して、有機 E L 素子 O L E D に順バイアス方向に所定の発光駆動電流 (出力電流) I b が流れ、有機 E L 素子 O L E D が発光する。ここで、キャパシタ C s により蓄積された電荷に基づく電位差 (充電電圧) は、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 において階調電流 I p i x に対応した書込電流 I a を流す場合の電位差に相当するので、有機 E L 素子 O L E D に供給される発光駆動電流 I b は、上記書込電流 I a と同等の電流値を有することになる。これにより、書込動作期間 T s e 後の非選択期間 T n s e においては、書込動作期間 T s e に書き込まれた表示データ (階調電流 I p i x) に対応する電圧成分に基づいて、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 を介して、発光駆動電流 I b が継続的に供給されることになり、有機 E L 素子 O L E D は表示データに対応する輝度階調で発光する動作を継続する。

20

そして、上述した一連の動作を、(i + 1) 行目以降の表示パネル 1 1 0 の全ての行 (走査ライン S L) について順次繰り返し実行することにより、表示パネル一画面分の表示データが書き込まれて、所定の輝度階調で発光動作し、所望の画像情報が表示される。

【 0 0 7 8 】

ここで、本実施形態に係る画素駆動回路 D C においては、トランジスタ T r 2 1 、 T r 2 2 及びダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 の半導体層 (チャネル層) がいずれも n チヤネル型により形成されている場合について示したが、この場合、半導体層としてアモルファスシリコンを適用し、すでに確立されたアモルファスシリコン製造技術を適用して、素子特性 (電子移動度等) の安定した画素駆動回路を比較的安価に製造することができる。

30

【 0 0 7 9 】

また、本実施形態に係る画素駆動回路 D C においては、上述したように (図 6 参照)、電源電圧ライン V L に所定の電圧値を有する電源電圧 V s c を印加する必要がある、そのための構成として、図 1 に示したように、電源ドライバ 1 3 0 を備えた構成を示したが、これに限定されるものではなく、例えば、電源電圧 V s c が走査信号 V s e l に同期するタイミングで電源電圧ライン V L に印加されることから、走査ドライバ 1 2 0 において、走査信号 V s e l (又は、走査信号を生成するためのシフト信号) を反転処理し、所定の電圧レベルに増幅して、電源電圧 V s c として各電源電圧ライン V L に印加するようにした構成を有するものであってもよい。

40

【 0 0 8 0 】

なお、上述した表示画素 E M においては、電流指定型の階調制御方式に対応した画素駆動回路の一例として、同一のチャネル極性を有する 3 個のトランジスタを備え、表示画素 E M (画素駆動回路 D C) からデータライン D L を介してデータドライバ 1 4 0 方向に表示データに応じた階調電流 I p i x を引き込む形態の回路構成を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば 4 個のトランジスタを備えた回路構成を有するものであ

50

ってもよいし、さらには、データドライバからデータラインを介して表示画素（画素駆動回路）方向に階調電流を流し込む形態の回路構成を有するものであってもよい。

【0081】

また、上述した表示画素EMにおいては、電流制御型の発光素子として、有機EL素子を適用した構成を示したが、これに限定されるものではなく、画素駆動回路から供給される発光駆動電流の電流値に応じて所定の輝度階調で発光動作する発光素子であれば、例えば、発光ダイオードやその他の発光素子を適用するものであってもよい。

【0082】

< 本発明における効果の検証 >

次に、本実施形態に係る表示画素（画素駆動回路）及び該表示画素を2次元配列した表示パネルを備えた画像表示装置の効果について具体的に説明する。

まず、上述した回路構成を有する画素駆動回路における容量成分（保持容量及び寄生容量）の接続状態について詳しく検討する。

【0083】

図8は、同一の素子構造を有するトランジスタを適用した画素駆動回路（比較対象）における容量成分の接続状態を示す概念図である。ここで、図8においては、図2に示した本発明に係る画素駆動回路DCと同等の回路構成において、発光駆動用のスイッチング素子であるダブルゲート型トランジスタTr13に替えて、トランジスタTr11、Tr12と同様の電界効果型のトランジスタを適用した場合の画素駆動回路DCxを示し、本発明に対する比較対象として説明する。なお、図8に示した画素駆動回路においては、図2

10

20

【0084】

まず、発光駆動用のスイッチング素子として、図2に示した画素駆動回路DCにおけるダブルゲート型トランジスタTr13に替えて、トランジスタTr11、Tr12と同様に、周知の電界効果型のトランジスタTr23を適用した場合の回路構成を図8(a)に示す。ここで、電界効果型のトランジスタTr21~Tr23は、ゲート電極とソース電極、及び、ゲート電極とドレイン電極がいずれもゲート絶縁膜を介して対向するように形成されているため、ゲート-ソース間、及び、ゲート-ドレイン間にそれぞれ寄生容量が生じる。

【0085】

そのため、図8(a)に示した回路構成を有する表示画素EMx（画素駆動回路DCx）においては、図8(b)に示すように、トランジスタTr21には、走査ラインSLに接続されたゲート電極と接点N21に接続されたソース電極との間に寄生容量Cgs1が形成され、該ゲート電極と電源電圧ラインVLに接続されたドレイン電極との間に寄生容量Cgd1が形成される。また、トランジスタTr22においては、走査ラインSLに接続されたゲート電極と接点N22に接続されたソース電極との間に寄生容量Cgs2が形成され、該ゲート電極とデータラインDLに接続されたドレイン電極との間に寄生容量Cgd2が形成される。また、トランジスタTr23においては、接点N21に接続されたゲート電極と接点N22に接続されたソース電極との間に寄生容量Cgs3が形成され、該ゲート電極と電源電圧ラインVLに接続されたドレイン電極との間に寄生容量Cgd3が形成される。

30

40

【0086】

また、有機EL素子OLEDは、ダイオード接合構造を有しているので、アノード電極とカソード電極との間に、接合容量に起因する寄生容量Coledが形成され、また、データラインDLと走査ラインSL間、データラインDLと電源電圧ラインVL間にも配線容量（寄生容量）Cd-s、Cd-vが形成される。また、接点N21とN22との間には、保持容量としてのキャパシタCxが接続されている。

【0087】

そして、このような各種の容量成分が表示画素EMx（画素駆動回路DCx）の駆動制御動作（上述した画素駆動回路DCと同等の駆動制御動作）に及ぼす影響は、概ね、次の

50

ように説明することができる。

上述した画素駆動回路 D C の駆動制御方法として図 6 のタイミングチャートに示したように、図 8 (a)、(b) に示した表示画素 E M x (画素駆動回路 D C x) を選択状態から非選択状態に切り替えた場合の走査信号 V sel の電圧の差 ΔV_{sel} は、次の (1) 式により表される。

【 0 0 8 8 】

$$\Delta V_{sel} = V_{sel}(L) - V_{sel}(H) \quad \cdots (1)$$

ここで、 $V_{sel}(L)$ は選択状態解除直後 (非選択状態) における走査信号 V sel の電圧値であり、 $V_{sel}(H)$ は選択状態解除直前 (選択状態) における走査信号 V sel の電圧値である。

10

この電位変動に伴って各寄生容量、保持容量間に変位電流が流れるが、選択状態と非選択状態とでキャパシタ C x に蓄積された電荷が保持され、各接点 N 2 1、N 2 2 に流れ込む変位電流の和は 0 であることから、次の (2)、(3) 式が得られる。

【 0 0 8 9 】

【 数 1 】

$$C_{gs2} \cdot (\Delta V_{sel} - \Delta V_{n22}) + (C_{gs3} + C_x) \cdot (\Delta V_{n21} - \Delta V_{n22}) - C_{oled} \cdot \Delta V_{n22} = 0 \quad \cdots (2)$$

20

$$C_{gs1} \cdot (\Delta V_{sel} - \Delta V_{n21}) + C_{gd3} \cdot (\Delta V_{sc} - \Delta V_{n21}) + (C_{gs3} + C_x) \cdot (\Delta V_{n22} - \Delta V_{n21}) = 0 \quad \cdots (3)$$

【 0 0 9 0 】

ここで、 ΔV_{n21} 、 ΔV_{n22} は各々接点 N 2 1、N 2 2 における電位変化であり、 ΔV_{sc} は表示画素 E M x (画素駆動回路 D C x) を選択状態から非選択状態に切り替えた場合の電源電圧 V sc の差である。なお、電位変動が瞬時にではなく緩やかに生じる場合には変位電流の他に、コンダクタンスに起因する電流も流れることになるが、ここでは上記の電位変動が瞬時に生じるものとする。

30

次いで、上記 (2)、(3) 式において、接点 N 2 1、N 2 2 における電位変化 ΔV_{n21} 、 ΔV_{n22} について解いて、(4) 式に示すように、差分 $\Delta (V_{n21} - V_{n22}) = \Delta V_{n21} - \Delta V_{n22}$ を求める。

【 0 0 9 1 】

【 数 2 】

$$\Delta (V_{n21} - V_{n22}) = A / B \quad \cdots (4)$$

$$\begin{cases} A = (C_{oled} \cdot C_{gs1} - C_{gd3} \cdot C_{gs2}) \cdot \Delta V_{sel} + (C_{gs2} + C_{oled}) \cdot C_{gd3} \cdot \Delta V_{sc} \\ B = (C_{gs2} + C_{oled}) \cdot (C_{gs1} + C_{gd3}) \\ \quad + (C_{gs2} + C_{oled} + C_{gs1} + C_{gd3}) \cdot (C_{gs3} + C_x) \end{cases}$$

40

【 0 0 9 2 】

ここで、(4) 式で差分 $\Delta V_{n21} - \Delta V_{n22}$ として表される電位変動は、トランジスタ T r 2 3 におけるゲート電圧 (ゲート - ソース間電圧) の変動 $\Delta V_{gs} - T3$ に相当し、当該トランジスタ T r 2 3 のドレイン - ソース間に流れる電流変動に対応している。

このように、表示画素 E M x (画素駆動回路 D C x) を選択状態と非選択状態との間で切替制御することにより、発光駆動用のスイッチング素子であるトランジスタ T r 2 3 の

50

ゲート電極に印加されるゲート電圧（ゲート - ソース間電圧） V_{gs} が変化する。

【0093】

一方、図8(a)に示した画素駆動回路DCxにおいては、トランジスタTr23の電流路（ソース - ドレイン）が接点N22を介して有機EL素子OLEDのアノード電極に接続され、これらのトランジスタTr23と有機EL素子OLEDからなる直列回路が電源電圧ライン（電源電圧 V_{sc} ）と接地電位GNDとの間に接続されている。ここで、図6に示したような駆動制御動作を実行した場合、走査信号Vselの切換タイミングに同期して電源電圧 V_{sc} が変化するため、トランジスタTr23の電流路の両端（ドレイン - ソース間）に印加される電圧 V_{ds} が変化することになる。

【0094】

そのため、当該表示画素Emx（画素駆動回路DCx）への書込電流（指定電流）に対する発光駆動電流（出力電流）に差異が生じ、表示データに応じた適切な輝度階調で発光素子を発光動作させることができず、コントラストの低下等を生じて表示画質の劣化を招くという問題を有していた。

【0095】

ここで、発光駆動用のスイッチング素子であるトランジスタTr23の動作特性について詳しく検証する。

図9は、比較対象として示した画素駆動回路に適用される発光駆動用トランジスタの動作特性を示す図である。ここで、図9(a)に示した電界効果型トランジスタの断面構造においては、図3、図5に対応する構成については、同等の符号を付して示す。また、図9(b)は、表1に示したようなパラメータ（絶縁膜の比誘電率と膜厚、及び、素子寸法）を有するトランジスタを適用した場合の動作特性（電圧 - 電流特性）を示すものである。

【0096】

【表1】

<絶縁膜の比誘電率と膜厚>

	比誘電率 ϵ	膜厚d (nm)
LYR5	3	1.0E+06
LYR4	7.5	200
LYR3	7.5	170
LYR2	12	50
LYR1	7.5	250

<トランジスタ素子寸法>

	寸法(μm)
ソース電極重なり長さ X_s	2
ドレイン電極重なり長さ X_d	2
チャネル長L	7
チャネル幅W	600

【0097】

すなわち、図9(a)に示すような素子構造を有する電界効果型のトランジスタTr23において、表1に示すように、絶縁性基板11に形成されたゲート電極Tr23g上に形成されたゲート絶縁膜12（LYR1）は、比誘電率 $\epsilon = 7.5$ 、膜厚 $d_1 = 250 \text{ nm}$ （2500）に設定され、ゲート絶縁膜12上に形成されたアモルファスシリコンからなる半導体層SMC（LYR2）は、比誘電率 $\epsilon = 12$ 、膜厚 $d_2 = 50 \text{ nm}$ （500）に設定され、半導体層SMC上に形成されたブロック絶縁膜BL（LYR3）は、比誘電率 $\epsilon = 7.5$ 、膜厚 $d_3 = 170 \text{ nm}$ （1700）に設定され、ブロック絶縁膜BL上に形成された絶縁膜13（LYR4）は、比誘電率 $\epsilon = 7.5$ 、膜厚 $d_4 = 200 \text{ nm}$ （2000）に設定されている。

【0098】

また、電界効果型のトランジスタTr23において、図9(a)の左右方向（ソース - ドレイン間方向）におけるブロック絶縁膜BLと半導体層SMCとの重なり長さに相当するチャネル長Lは $7 \mu m$ に設定され、図9(a)の紙面に垂直方向（ソース、ドレインに並行する方向）におけるブロック絶縁膜BLと半導体層SMCとの重なり長さに相当する

チャンネル幅 W は $600\text{ }\mu\text{m}$ に設定され、図 9 (a) の左右方向 (ソース - ドレイン間方向) におけるソース電極 Tr_{23s} とチャンネル領域の重なり長さ X_s 、及び、ドレイン電極 Tr_{23d} とチャンネル領域の重なり長さ X_d はいずれも $2\text{ }\mu\text{m}$ に設定されている。

【 0 0 9 9 】

このようなトランジスタ Tr_{23} におけるドレイン・ソース間電圧 V_{ds} とドレイン・ソース間電流 I_{ds} の関係 (電圧 - 電流特性) は、図 9 (b) 中、実線で示した特性線 SP_x 、 SP_y のように、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} の低い領域では、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} の増加に伴ってドレイン・ソース間電流 I_{ds} が急峻に増加する傾向を示し、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} の高い領域では、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} の増加に伴ってドレイン・ソース間電流 I_{ds} が徐々に収束する飽和傾向を示す。

10

【 0 1 0 0 】

また、図 9 (b) 中、一点鎖線で示した特性線 SP_w は、表示画素 EM_x (画素駆動回路 DC_x) を選択状態に設定して (つまり、トランジスタ Tr_{21} をオン動作して、トランジスタ Tr_{23} のゲート - ドレイン間を接続した状態に設定して) 、表示データに応じた指定電流を引き抜く書込動作時におけるドレイン・ソース間電圧 V_{ds} とドレイン・ソース間電流 I_{ds} の関係を示す特性線であり、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} の増加に伴い、ドレイン・ソース間電流 I_{ds} が非線形的に増加する。

【 0 1 0 1 】

ここで、図 9 (b) に示した特性線 SP_x は、表示画素 EM_x (画素駆動回路 DC_x) を選択状態に設定し、表示データに応じた階調電流を引き抜いて書込動作を実行する際の、トランジスタ Tr_{23} の動作特性 (ゲート電圧 $V_g = 8.1\text{ V}$ におけるドレイン・ソース間電圧 V_{ds} に対するドレイン・ソース間電流 I_{ds}) を示し、特性線 SP_y は、表示画素 EM_x (画素駆動回路 DC_x) を非選択状態に設定した際の、トランジスタ Tr_{23} の動作特性 (ゲート電圧 $V_g = 8.6\text{ V}$ におけるドレイン・ソース間電圧 V_{ds} に対するドレイン・ソース間電流 I_{ds}) を示している。

20

【 0 1 0 2 】

そして、表示画素 EM_x (画素駆動回路 DC_x) を選択状態から非選択状態に切換制御した場合、上述したように、トランジスタ Tr_{23} に印加されるゲート電圧 (ゲート・ソース間電圧) V_{gs} 、及び、トランジスタ Tr_{23} の電流路の両端 (ドレイン - ソース間) に印加される電圧 V_{ds} が変化することになるため、図 9 (b) に示すように、表示画素 EM_x (画素駆動回路 DC_x) への書込電流 (階調電流) として、例えば $3\text{ }\mu\text{A}$ ($3.0\text{ E} - 06\text{ A}$) の電流値を指定した場合 (図中、特性線 SP_x 上に白丸で表記) であっても、表 1 に示したパラメータを有するトランジスタ Tr_{23} においては、上記ゲート電圧 V_g に 0.5 V の電圧変化 ($8.6 - 8.1\text{ V}$) が発生する。

30

【 0 1 0 3 】

これにより、トランジスタ Tr_{23} の動作特性が変化して (特性線 $SP_x \rightarrow SP_y$) 、 $5.1\text{ }\mu\text{A}$ の電流値 (図中、特性線 SP_y 上に黒丸で表記) を有する発光駆動電流 (出力電流) が有機 EL 素子 OLED に供給されることになり、書込電流に対する発光駆動電流に差異が生じて、表示データに応じた適切な輝度階調で発光素子を発光動作させることができなかった。

40

【 0 1 0 4 】

そこで、本発明においては、図 2 ~ 図 5 に示したように、発光駆動用のスイッチング素子としてダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} を適用し、半導体層 SMC の上方及び下方に設けられた一対のゲート電極 (トップゲート電極、ボトムゲート電極) のうち、いずれか一方に選択制御に基づく制御電圧 (ゲート電圧) を印加し、また、他方のゲート電極を有機 EL 素子 OLED に接続された接点 N_{12} 又は該ダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} のソース電極に接続した回路構成を有していることにより、表示画素 EM (画素駆動回路 DC) の駆動制御動作に起因する電圧変化が、ダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} のゲート電圧に及ぼす影響を抑制するようにしている。

【 0 1 0 5 】

50

図10は、本実施形態に係る画素駆動回路に適用される発光駆動用トランジスタの動作特性を示す図である。ここで、図10(a)に示した電界効果型トランジスタの断面構造においては、図3、図5に対応する構成については、同等の符号を付して示す。また、図10(b)は、表2に示したようなパラメータ(絶縁膜の比誘電率と膜厚、及び、素子寸法)を有するトランジスタを適用した場合の動作特性(電圧-電流特性)を示すものである。

【0106】

【表2】

<絶縁膜の比誘電率と膜厚>

	比誘電率 ϵ	膜厚 d (nm)
LYR5	7.5	1.0E-13
LYR4	7.5	200
LYR3	7.5	170
LYR2	12	50
LYR1	7.5	250

<トランジスタ素子寸法>

	寸法(μm)
ソース電極重なり長さ X_s	2
ドレイン電極重なり長さ X_d	2
チャネル長 L	7
チャネル幅 W	600

10

【0107】

すなわち、図10(a)に示すような素子構造を有するダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} において、表2に示すように、絶縁性基板11に形成されたボトムゲート電極 Tr_{13bg} 上に形成されたゲート絶縁膜(ボトムゲート絶縁膜)12(LYR1)は、比誘電率 $\epsilon = 7.5$ 、膜厚 $d_1 = 250\text{ nm}$ (2500)に設定され、ゲート絶縁膜12上に形成されたアモルファスシリコンからなる半導体層SMC(LYR2)は、比誘電率 $\epsilon = 12$ 、膜厚 $d_2 = 50\text{ nm}$ (500)に設定され、半導体層SMC上に形成されたブロック絶縁膜BL(LYR3)は、比誘電率 $\epsilon = 7.5$ 、膜厚 $d_3 = 170\text{ nm}$ (1700)に設定され、ブロック絶縁膜BL上に形成された絶縁膜13(LYR4)は、比誘電率 $\epsilon = 7.5$ 、膜厚 $d_4 = 200\text{ nm}$ (2000)に設定されている。

20

【0108】

なお、ダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} におけるチャネル長 L 、チャネル幅 W 、及び、ソース電極 Tr_{13s} とチャネル領域の重なり長さ X_s 、及び、ドレイン電極 Tr_{13d} とチャネル領域の重なり長さ X_d は、表2に示すように、上述した比較対象となるトランジスタ Tr_{23} と同一の寸法(表1参照)になるように設定されている。

30

【0109】

このようなダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} におけるドレイン・ソース間電圧 V_{ds} とドレイン・ソース間電流 I_{ds} の関係(電圧-電流特性)は、上述した比較対象における場合と同様に、図10(b)中、実線で示した特性線SPa、SPbのように、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} の低い領域では、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} の増加に伴ってドレイン・ソース間電流 I_{ds} が急峻に増加する傾向を示し、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} の高い領域では、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} の増加に伴ってドレイン・ソース間電流 I_{ds} が徐々に収束する飽和傾向を示す。特に、飽和領域においては、図9(b)に示した比較対象における場合に比較して、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} に対するドレイン・ソース間電流 I_{ds} の増加量が小さく抑制される。

40

【0110】

ここで、図10(b)に示した特性線SPaは、表示画素EM(画素駆動回路DC)を選択状態に設定し、表示データに応じた階調電流を引き抜いて書込動作を実行する際の、ダブルゲート型トランジスタ Tr_{13} の動作特性(ゲート電圧 $V_g = 8.3\text{ V}$ におけるドレイン・ソース間電圧 V_{ds} に対するドレイン・ソース間電流 I_{ds})を示し、特性線SPbは、表示画素EM(画素駆動回路DC)を非選択状態に設定した際の、トランジスタ Tr_{23} の動作特性(ゲート電圧 $V_g = 8.8\text{ V}$ におけるドレイン・ソース間電圧 V_{ds} に対するドレイン・ソース間電流 I_{ds})を示している。

50

【 0 1 1 1 】

そして、表示画素 E M (画素駆動回路 D C) を選択状態から非選択状態に切換制御した場合、上述したように、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 に印加されるゲート電圧 (ゲート - ソース間電圧) V_{gs} 、及び、トランジスタ T r 1 3 の電流路の両端 (ドレイン - ソース間) に印加される電圧 V_{ds} が変化することになるが、図 1 0 (b) に示すように、表示画素 E M (画素駆動回路 D C) への書込電流 (階調電流) として、例えば $3 \mu A$ ($3 \cdot 0 E - 0 6 A$) の電流値を指定した場合 (図中、特性線 S P a 上に白丸で表記)、表 2 に示したパラメータを有するダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 を発光駆動用トランジスタに適用した場合においては、上記ゲート電圧 V_g に $0.5 V$ の電圧変化 ($8.8 - 8.3 V$) が発生して、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 における動作特性が変化 (特性線 S P a $\rightarrow$ S P b) するものの、 $4.7 \mu A$ の電流値 (図中、特性線 S P b 上に黒丸で表記) を有する発光駆動電流が有機 E L 素子 O L E D に供給されて、上述した比較対象よりも小さく抑制される。

10

【 0 1 1 2 】

すなわち、発光駆動用のスイッチング手段として、トップゲート電極がソース電極に接続されたダブルゲート型トランジスタを用いた場合、電界効果型トランジスタを用いた場合 (比較対象) に比較して、書込電流に対する発光駆動電流の差異が小さく抑制されるので、表示データに比較的対応した輝度階調で発光素子を発光動作させることができる。このようなダブルゲート型トランジスタ特有の効果は、次のように説明することができる。

【 0 1 1 3 】

20

図 1 1 は、本実施形態に係る画素駆動回路に適用されるダブルゲート型トランジスタにおける素子構造とチャネル電位との関係を説明するための図である。ここで、図 1 1 (a) においては、図示の都合上、断面図のハッチングの一部を省略して示す。

すなわち、例えば図 1 1 (a) に示すような薄膜トランジスタ構造 (すなわち、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 のトップゲート電極 T r 1 3 t g を取り除いた素子構造、もしくは、ダブルゲート型トランジスタ T r 1 3 において、トップゲート端子 T r 1 3 t g に独立したゲート電圧を印加していない状態) において、ソース電極 T r 1 3 s 及びドレイン電極 T r 1 3 d が半導体層 S M C 上のブロック絶縁膜 B L 上に延在することにより、擬似的なトップゲート電極としての役割を果たすことに起因するものと説明することができる。

30

【 0 1 1 4 】

具体的には、図 1 1 (a) に示した素子構造を有するトランジスタにおいては、半導体層 S M C 上にブロック絶縁膜 B L を介してソース電極 T r 1 3 s 及びドレイン電極 T r 1 3 d が重なっている領域では、これら電極に印加された電圧により半導体層 S M C にチャネル領域が形成され、ソース電極 T r 1 3 s 及びドレイン電極 T r 1 3 d が形成されていない領域に形成される本来のチャネル領域 (すなわち、トップゲート電極 T r 1 3 t g に印加されたゲート電圧により半導体層 S M C に形成されるチャネル領域) に加え、ソース電極 T r 1 3 s 及びドレイン電極 T r 1 3 d に対応する領域にもチャネル領域が形成されることにより、ソース電極 T r 1 3 s からドレイン電極 T r 1 3 d に至る領域の半導体層 S M C にチャネル領域 R c h が形成される。このとき、チャネル領域 R c h には、ソース - ドレイン間に印加されるバイアス電圧 (ソース電圧及びドレイン電圧) に応じた電位変化が生じる。

40

【 0 1 1 5 】

図 1 1 (b) に示すように、ソース - ドレイン間に所定のバイアス電圧が印加され、ソース電極 T r 1 3 s に低電位電圧 V_{sl} (例えば $0 V$) が、また、ドレイン電極 T r 1 3 d に高電位電圧 V_{dh} が印加されると、低電位電圧 V_{sl} が印加されるソース電極 T r 1 3 s 側 (ソース電極 T r 1 3 s とブロック絶縁膜 B L が重なる領域) ではチャネル電位を下げる方向 (負の方向)、すなわち電圧 V_{sl} に収束 (近似) する方向に作用して、オン電流 (ドレイン・ソース間電流 I_{ds}) が抑制され、一方、高電位電圧 V_{dh} が印加されるドレイン電極 T r 1 3 d 側 (ドレイン電極 T r 1 3 d とブロック絶縁膜 B L が重なる領域) ではチャ

50

ネル電位を上げる方向（正の方向）、すなわち電圧 V_{dh} に収束（近似）する方向に作用して、オン電流が増大する。なお、図 11（b）において、細い実線で示した特性線 S_{Pv} は、チャネル領域における（チャネル位置に対する）電位変化の理想値を示す。

【0116】

これに対し、上述したダブルゲート型トランジスタ T_{r13} においては、トップゲート電極 T_{r13tg} がソース電極 T_{r13s} に接続された構成を有している。これにより、図 11（b）に示した、ソース電極 T_{r13s} 側での、チャネル電位を下げてオン電流を抑制する効果がトップゲート電極 T_{r13tg} によって更に助長され、ドレイン・ソース間電圧 V_{ds} に対するドレイン・ソース間電流 I_{ds} の増加量が抑制される。

【0117】

このことから、画素駆動回路 DC の発光駆動用のスイッチング素子として、図 3、図 5 に示したようなダブルゲート型トランジスタを適用し、かつ、当該ダブルゲート型トランジスタのトップゲート電極にソース電極と同一の電位を印加することにより、電圧・電流特性の飽和領域におけるドレイン・ソース間電圧 V_{ds} に対するドレイン・ソース間電流（出力電流） I_{ds} の増加量を抑制することができるとともに、ゲート・ソース間電圧（ゲート電圧） V_{gs} の変化に対するドレイン・ソース間電流 I_{ds} の増加量を抑制することができる。

【0118】

したがって、表示画素 EM（画素駆動回路 DC）の駆動制御動作において、選択状態から非選択状態へ切換制御する際に、発光駆動用のスイッチング素子であるダブルゲート型トランジスタのゲート電極に印加される電圧が変化した場合であっても、発光駆動用のスイッチング素子として周知の電界効果型トランジスタを適用した場合（上述した比較対象）に比較して、上記電圧変化が同じであっても書込電流（指定電流）に対する発光駆動電流（出力電流）の差異が低減されるので、表示データに比較的対応した輝度階調で発光素子を発光動作させることができる。

【0119】

また、この場合、図 5 に示したように、発光駆動用のスイッチング素子となるダブルゲート型トランジスタ T_{r13} のトップゲート電極 T_{r13tg} として、ソース電極 T_{r13s} に電氣的に接続された画素電極（有機 EL 素子 OLED のアノード電極）14 をダブルゲート型トランジスタ T_{r13} の半導体層 SMC 上にまで延在させて、当該画素電極 14 と一体的に形成することができるので、画素電極 14 のバタニング用のマスクを変更するのみで、新たな工程を付加することなく、従来技術の製造プロセスをそのまま適用して簡易に形成することができる。

【0120】

なお、上述した実施形態においては、画素駆動回路に発光駆動用のスイッチング素子として設けられたダブルゲート型トランジスタの、トップゲート電極とソース電極を電氣的に接続した回路構成及び素子構造を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ダブルゲート型トランジスタを構成する半導体層のチャネル極性に応じて、トップゲート電極とドレイン電極を接続するものであってもよい。

【0121】

また、上記ダブルゲート型トランジスタのトップゲート電極と一体的に形成される画素電極について、表示パネル（表示画素）の発光構造に応じて、トップゲート電極（画素電極）を光反射特性（すなわち、光遮断特性）を有する電極材料により形成することができることを説明したが、この場合、ダブルゲート型トランジスタのチャネル領域（半導体層）が遮光されるので、外光の入射に起因する光誘起リーク電流を低減することができるのと同時に、外部電界の影響（例えば近接する電極や配線による影響）を遮蔽（シールド）することができる。

【0122】

また、上述した実施形態においては、画素駆動回路に発光駆動用のスイッチング素子にのみダブルゲート型トランジスタを適用した回路構成及び素子構造を示したが、本発明は

10

20

30

40

50

これに限定されるものではなく、画素駆動回路を構成する他のトランジスタ（すなわちトランジスタ $Tr11$ 、 $Tr12$ ）としてダブルゲート型トランジスタを適用するものであってもよい。この場合、トランジスタ $Tr11$ 、 $Tr12$ に適用されるダブルゲート型トランジスタのトップゲート電極を不透明な電極材料を用いて形成することにより、外光のチャネル領域への入射が遮光され、光誘起リーク電流の低減や、外部電界の影響を遮蔽することができる。

【図面の簡単な説明】

【0123】

【図1】本発明に係る画像表示装置の一実施形態を示す概略ブロック図である。

【図2】本実施形態に係る表示装置に適用可能な表示画素（画素駆動回路）の具体回路例を示す回路構成図である。

【図3】本実施形態に係る画素駆動回路に適用可能なダブルゲート型トランジスタの素子構造の例を示す断面構成図である。

【図4】本実施形態に係る表示装置（表示パネル）に適用可能な表示画素の一例を示す平面レイアウト図である。

【図5】図4に示した平面レイアウトを有する表示画素におけるA-A断面を示す概略断面図である。

【図6】本実施形態に係る画素駆動回路を適用した表示画素の基本動作を示すタイミングチャートである。

【図7】本実施形態に係る画素駆動回路の動作状態を示す概念図である。

【図8】同一の素子構造を有するトランジスタを適用した画素駆動回路（比較対象）における容量成分の接続状態を示す概念図である。

【図9】比較対象として示した画素駆動回路に適用される発光駆動用トランジスタの動作特性を示す図である。

【図10】本実施形態に係る画素駆動回路に適用される発光駆動用トランジスタの動作特性を示す図である。

【図11】本実施形態に係る画素駆動回路に適用されるダブルゲート型トランジスタにおける素子構造とチャネル電位との関係を説明するための図である。

【図12】従来技術における発光素子型ディスプレイの要部を示す概略構成図である。

【図13】従来技術における発光素子型ディスプレイに適用可能な表示画素（画素駆動回路及び発光素子）の構成例を示す等価回路図である。

【符号の説明】

【0124】

100	画像表示装置
110	表示パネル
120	走査ドライバ
130	電源ドライバ
140	データドライバ
EM	表示画素
DC	画素駆動回路
OLED	有機EL素子
SL	走査ライン
VL	電源電圧ライン
DL	データライン
$Tr11$ 、 $Tr12$	電界効果型のトランジスタ
$Tr13$	ダブルゲート型トランジスタ
$Tr13tg$	トップゲート電極
$Tr13bg$	ボトムゲート電極
14	画素電極（アノード電極）
17	対向電極（カソード電極）

10

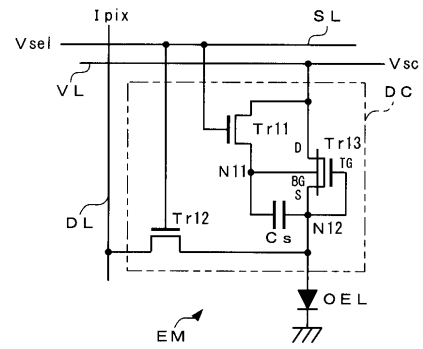
20

30

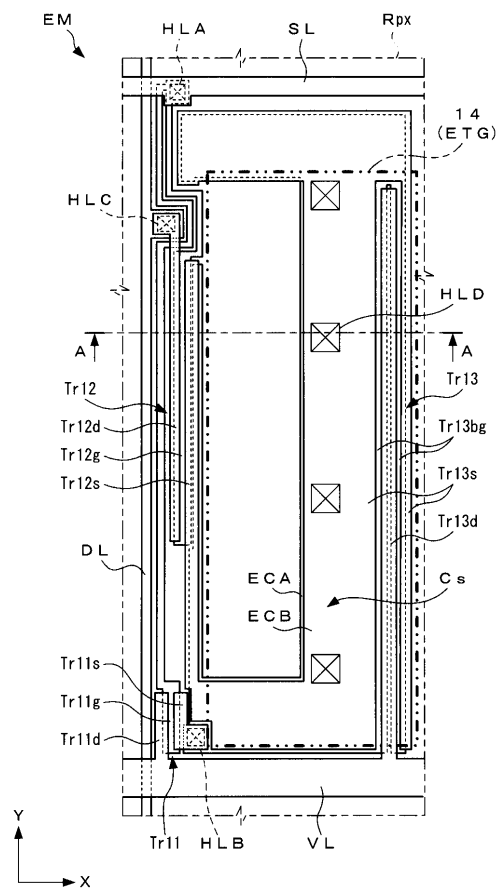
40

50

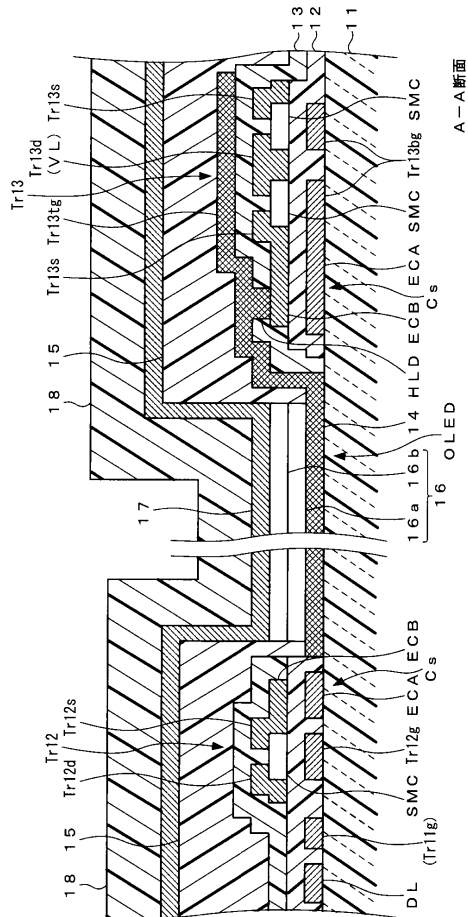
【 図 2 】



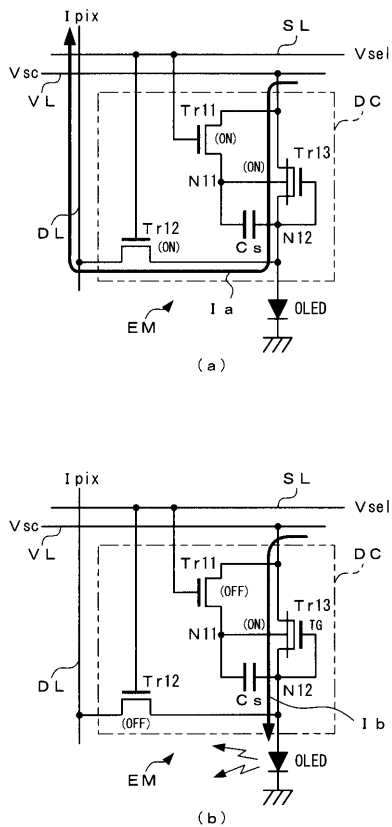
【 図 4 】



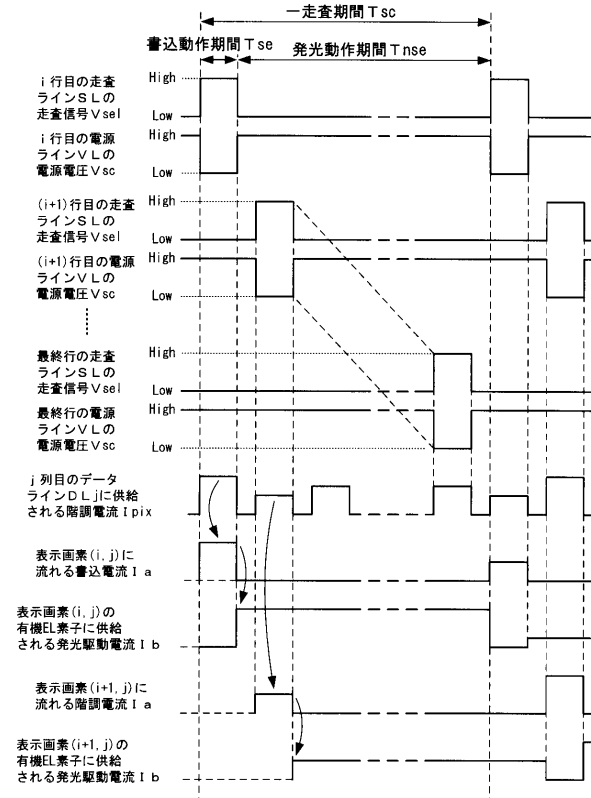
【 図 5 】



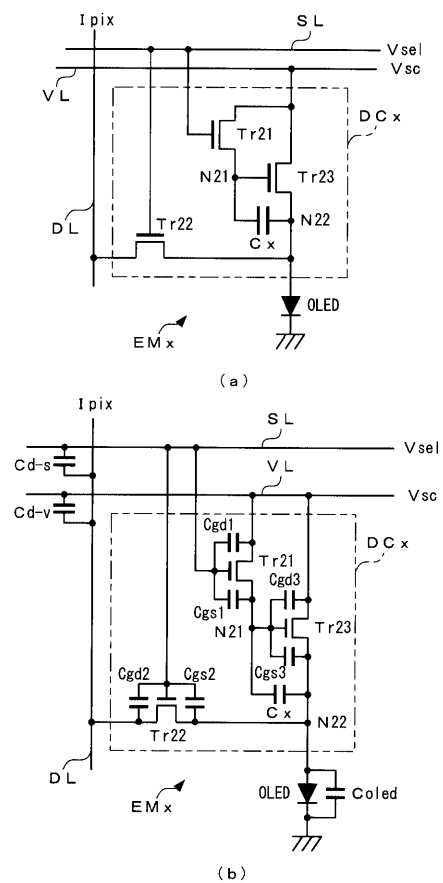
【圖 7】



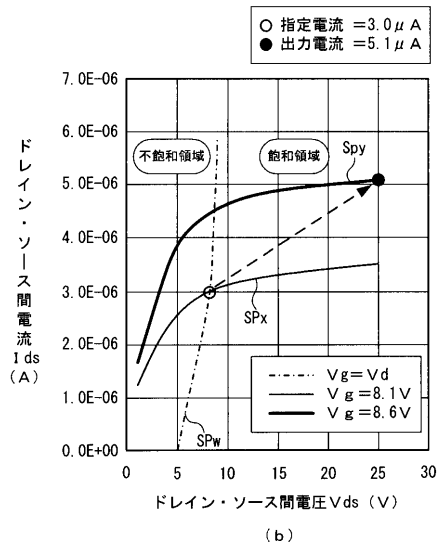
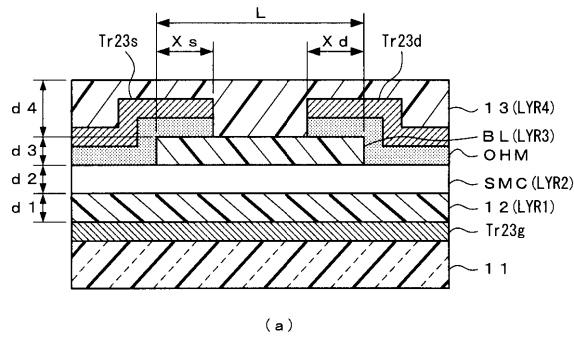
【 図 6 】



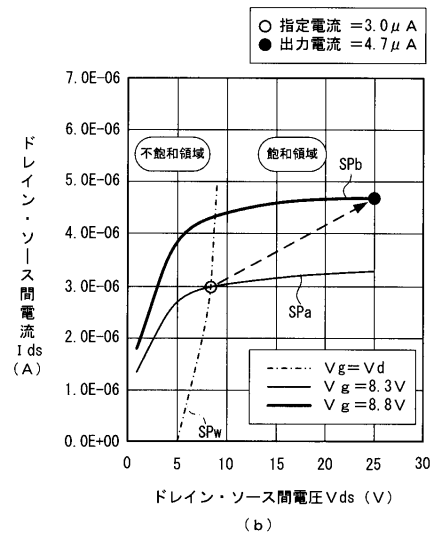
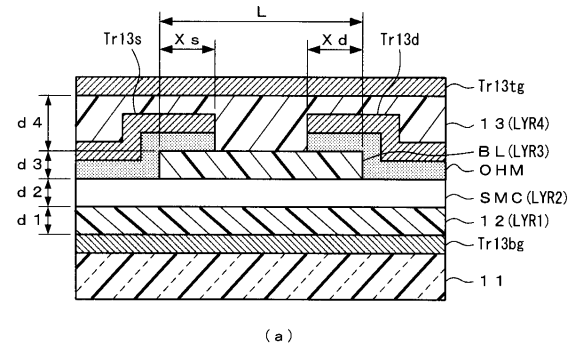
【 図 8 】



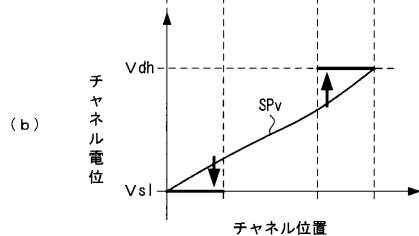
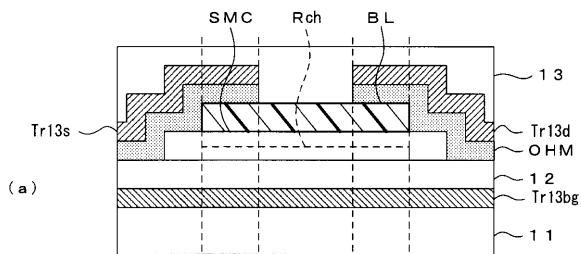
【図 9】



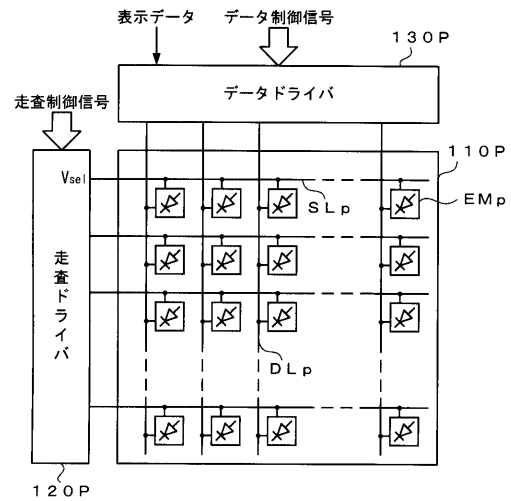
【図 10】



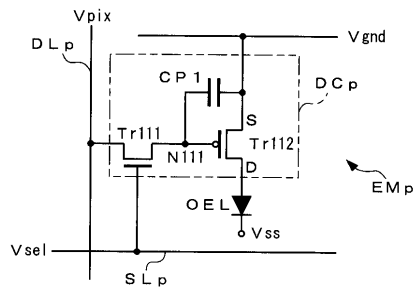
【図 11】



【図 12】



【図 13】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

テーマコード(参考)

H 0 1 L 29/78 6 1 4

H 0 1 L 29/78 6 1 7 N

F ターム(参考) 5F110 AA30 BB01 CC07 DD02 EE30 FF05 FF09 GG02 GG06 GG13
GG15 GG25 GG28 GG29 HL02 HL03 HL04 HL06 HL07 NN03
NN14 NN16 NN28 NN71 NN73

专利名称(译)	像素驱动电路和图像显示装置		
公开(公告)号	JP2008083171A	公开(公告)日	2008-04-10
申请号	JP2006260632	申请日	2006-09-26
[标]申请(专利权)人(译)	卡西欧计算机株式会社		
申请(专利权)人(译)	卡西欧计算机有限公司		
[标]发明人	武居学		
发明人	武居 学		
IPC分类号	G09G3/30 G09G3/20 H01L51/50 H01L21/336 H01L29/786		
FI分类号	G09G3/30.J G09G3/20.624.B G09G3/20.641.D H05B33/14.A H01L29/78.612.Z H01L29/78.614 H01L29/78.617.N G09G3/325 G09G3/3266 G09G3/3275 G09G3/3283		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC31 3K107/CC32 3K107/CC33 3K107/EE03 3K107/HH00 3K107/HH04 3K107/HH05 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/DD01 5C080/EE29 5C080/FF11 5C080/HH09 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ05 5F110/AA30 5F110/BB01 5F110/CC07 5F110/DD02 5F110/EE30 5F110/FF05 5F110/FF09 5F110/GG02 5F110/GG06 5F110/GG13 5F110/GG15 5F110/GG25 5F110/GG28 5F110/GG29 5F110/HL02 5F110/HL03 5F110/HL04 5F110/HL06 5F110/HL07 5F110/NN03 5F110/NN14 5F110/NN16 5F110/NN28 5F110/NN71 5F110/NN73 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380/AB11 5C380/AB12 5C380/AB22 5C380/AB31 5C380/BA36 5C380/BA39 5C380/BB02 5C380/BB21 5C380/BD02 5C380/BD05 5C380/CA04 5C380/CA08 5C380/CA13 5C380/CB01 5C380/CB16 5C380/CB31 5C380/CC13 5C380/CC27 5C380/CC30 5C380/CC33 5C380/CC52 5C380/CC62 5C380/CD012 5C380/CD013 5C380/CD043 5C380/DA02 5C380/DA06 5C380/HA05 5C380/HA06 5C380/HA13		
其他公开文献	JP4748456B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种像素驱动电路和图像显示装置，其能够通过抑制写入电流（指定电流）和发光驱动电流（输出）之间的差异来驱动与显示数据匹配的亮度的发光元件。当驱动显示像素（像素驱动电路）时由电压变化引起的电流）。ΣSOLUTION：在像素驱动电路DC中，用作发光驱动开关的双栅极晶体管Tr13和有机EL元件OLED串联连接。在双栅极晶体管Tr13中，其底部栅极端子BG连接到触点N11以将控制电压，其漏极端子D施加到电源电压线VL，并将其顶部栅极端子TG和源极端子S一起施加到触点N12连接到有机EL元件OLED的阳极端子。Ž

